

Предметный указатель

Содержание

1.	Персоналии	1514
2.	Обзоры	1514
3.	Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40)	1514
3.1.	Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px)	1515
4.	Структура, механические и термические свойства (PACS 60)	1515
4.1.	Структура, кристаллография (PACS 61)	1515
4.1.1.	Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16)	1516
4.1.2.	Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43)	1516
4.1.3.	Кластеры и наночастицы (PACS 61.46)	1516
4.1.4.	Дефекты в кристаллах (PACS 61.72)	1517
4.1.5.	Физические эффекты, связанные с облучением. Радиационные дефекты (PACS 61.80)	1518
4.2.	Механические и акустические свойства (PACS 62). Динамика решетки (PACS 63)	1518
4.3.	Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64)	1518
4.4.	Термические свойства (PACS 65). Диффузия и теплопроводность (PACS 66)	1518
4.5.	Структура поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 68)	1519
5.	Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70)	1520
5.1.	Электронные состояния (PACS 71)	1520
5.1.1.	Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)	1520
5.2.	Транспортные явления (PACS 72)	1521
5.2.1.	Явления электронной проводимости в полупроводниках (PACS 72.20)	1522
5.2.2.	Высокочастотные эффекты и эффекты обусловленные плазмой (PACS 72.30)	1523
5.2.3.	Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)	1523
5.3.	Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)	1523
5.3.1.	Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20)	1524
5.3.2.	Барьеры Шоттки (PACS 73.30)	1525
5.3.3.	Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40)	1526
5.3.4.	Транспортные явления в тонких пленках (PACS 73.50)	1527
5.4.	Сверхпроводимость (PACS 74). Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76)	1527
5.5.	Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства (PACS 77)	1528
5.6.	Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)	1528
5.6.1.	Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)	1529

5.6.2.	Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30)	1529
5.6.3.	Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)	1529
5.6.4.	Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т.п.) (PACS 78.66)	1531
5.7.	Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79)	1532
6.	Технология, материаловедение, применение полупроводников (PACS 80)	1532
6.1.	Методы получения и обработки полупроводниковых материалов (PACS 81; 82)	1532
6.2.	Полупроводниковые приборы (PACS 84; 85)	1533

1. Персоналии

Владимир Иванович Иванов-Омский

(к 70-летию со дня рождения). 4 508

Роль Дмитрия Николаевича Наследова в становлении и развитии физики и техники полупроводников А^{III}В^V (к 100-летию со дня рождения).

О.В. Емельяненко, Н.М. Колчанова, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев 8 897

Владимир Иделевич Перель

(к 75-летию со дня рождения). 4 508

2. Обзоры

Искусственные подложки GeSi для гетероэпитаксии — достижения и проблемы. Ю.Б. Болховитянов, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов, С.И. Чикичев

5 513

Полупроводниковые фотоэлектропреобразователи для ультрафиолетовой области спектра. Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг

9 1025

Модифицирование свойств Hg_{1-x}Cd_xTe низкоэнергетичными ионами. К.Д. Мынбасв, В.И. Иванов-Омский

10 1153

3. Электромагнетизм, оптика, акустика (PACS 40)

Тепловая и токовая перестройка длины волны излучения квантово-размерных лазеров диапазона 2.0—2.4 мкм. А.П. Астахова, А.Н. Баранов, А. Висе, А.Н. Именков, Н.М. Колчанова, Н.Д. Стоянов, А. Черняев, Д.А. Яреха, Ю.П. Яковлев

4 502

Светочувствительные свойства новых фотопроводящих полимеров на основе бихинолиловых комплексов рутения. Е.Л. Александрова, М.Я. Гойхман, И.В. Подешво, И.В. Гофман, В.В. Кудрявцев

7 846

- Расщепление резонансных оптических мод в микрорезонаторах Фабри—Перо. В.Г. Голубев, А.А. Дукин, А.В. Медведев, А.Б. Певцов, А.В. Селькин, Н.А. Феоктистов 7 860
- Фотонные кристаллы на основе композитов опал-GaP и опал-GaN: получение и оптические свойства.** Г.М. Гаджиев, В.Г. Голубев, М.В. Заморянская, Д.А. Курдюков, А.В. Медведев, J. Merz, A. Mintairov, А.Б. Певцов, А.В. Селькин, В.В. Травников, Н.В. Шаренкова 12 1449
- 3.1. Полупроводниковые лазеры (PACS 42.55.Px)**
- Особенности электролюминесценции инжекционных лазеров на основе вертикально-связанных квантовых точек вблизи порога лазерной генерации.** Н.Ю. Гордеев, С.В. Зайцев, Л.Я. Карачинский, В.И. Копчатов, И.И. Новиков, В.М. Устинов, П.С. Копьев 1 114
- О внутреннем квантовом выходе стимулированного излучения InGaAsP/InP-гетеролазеров ($\lambda = 1.55$ мкм).** Г.В. Скрынников, Г.Г. Зегря, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, В.В. Шамахов, И.С. Тарасов 2 243
- Одномодовые быстроперестраиваемые лазеры для диодно-лазерной спектроскопии.** А.П. Астахова, Т.Н. Данилова, А.Н. Именков, Н.М. Колчанова, Ю.П. Яковлев 8 985
- Особенности спонтанного и когерентного инфракрасного излучения лазеров, изготовленных на основе одиночного разъединенного гетероперехода II типа.** К.Д. Моисеев, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев . . . 8 1010
- Температурные характеристики низкопороговых высокоэффективных лазеров на квантовых точках, излучающих в диапазоне длин волн 1.25–1.29 мкм.** И.И. Новиков, М.В. Максимов, Ю.М. Шерняков, Н.Ю. Гордеев, А.Р. Ковш, А.Е. Жуков, С.С. Михрин, Н.А. Малеев, А.П. Васильев, В.М. Устинов, Ж.И. Алфёров, Н.Н. Леденцов, Д. Бимберг 10 1270
- Лазерная генерация на длине волны 1.5 мкм в структурах с квантовыми точками на подложках GaAs.** А.Е. Жуков, А.П. Васильев, А.Р. Ковш, С.С. Михрин, Е.С. Семенова, А.Ю. Егоров, В.А. Одноблюдов, Н.А. Малеев, Е.В. Никитина, Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, Ю.М. Шерняков, М.В. Максимов, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, Ж.И. Алфёров 12 1461
- GaInAsP/GaInP/AlGaInP-лазеры, излучающие на 780 нм, выращенные методом МОС-гидридной эпитаксии.** Д.А. Винокуров, С.А. Зорина, В.А. Капитонов, А.Ю. Лешко, А.В. Лютецкий, Д.Н. Николаев, Н.А. Пихтин, А.Л. Станкевич, Н.В. Фетисова, В.В. Шамахов, И.С. Тарасов 12 1473
- 4. Структура, механические и термические свойства (PACS 60)**
- 4.1. Структура, кристаллография (PACS 61)**
- Исследование фотоемкости диодов из кремния, легированного ванадием.** Х.Т. Игамбердиев, А.Т. Мамадалимов, Р.А. Муминов, Т.А. Усманов, Ш.А. Шоюсупов 1 29
- Влияние термического отжига на оптические и фотоэлектрические свойства пленок микрокристаллического гидрированного кремния.** А.Г. Казанский, Х. Мелл, П.А. Форш 2 235
- Слоистое строение пленок $Zn_{1-x}Cd_xSe$, выращенных газофазной эпитаксией из металлорганических соединений на подложках $Cd_{0.92}Zn_{0.08}S$ (0001).** В.П. Мартовицкий, В.И. Козловский, П.И. Кузнецов, Я.К. Скасырский, Г.Г. Якушева 3 310
- Структура и оптические свойства пленок C_{60} на полимерных подложках.** Ю.Ф. Бирюлин, В.Н. Згонник, Е.Ю. Меленевская, С.Н. Миков, С.С. Моливер, С.Е. Орлов, А.В. Новоселова, В.Д. Петриков, В.В. Розанов, Д.А. Сыкманов, М.А. Яговкина 3 365
- Оптическое отражение в твердых растворах $(Pb_{0.78}Sn_{0.22})_{1-x}In_xTe$ с высоким содержанием индия.** А.Н. Вейс, А.В. Нашекин 4 398
- Фоточувствительные структуры на монокристаллах $ZnIn_2Se_4$.** А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 4 432
- Фазовые превращения, инициируемые в тонких слоях аморфного кремния наносекундным воздействием излучения эксимерного лазера.** Г.Д. Ивлев, Е.И. Гацкевич 5 622
- Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и рентгеновский микроанализ монокристаллов на основе теллурида висмута.** И.В. Гасенкова, В.А. Чубаренко, Е.А. Тявловская, Т.Е. Свечникова . 6 661
- Получение и свойства монокристаллов $ZnFe_2S_4$ и структур на их основе.** А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius 6 681
- К вопросу об исследовании композитов на основе нанопористого углерода методом малоуглового рентгеновского рассеяния.** Э.А. Сморгонская 7 796
- Рентгенодифракционное исследование структуры нанопористого углерода, полученного из карбидных материалов.** Р.Н. Кютт, А.М. Данишевский, Э.А. Сморгонская, С.К. Гордеев 7 811
- Моделирование кинетики роста октаэдрических и пластинчатых кислородных преципитатов в кремнии.** В.В. Светухин, А.Г. Гришин, О.В. Приходько 7 871
- Управление параметрами массивов квантовых точек InAs–GaAs в режиме роста Странского–Крастанова.** Н.А. Черкашин, М.В. Максимов, А.Г. Макаров, В.А. Шукин, В.М. Устинов, Н.В. Луковская, Ю.Г. Мухомин, Г.Э. Цырлин, Н.А. Берт, Ж.И. Алфёров, Н.Н. Леденцов, Д. Бимберг 7 890
- Энергия миграции вакансий в кристаллах кремния p-типа.** Т.А. Пагава, З.В. Башеллейшвили 9 1058
- Термодинамическая устойчивость эпитаксиальных пленок GaInSb, InAsSb, GaInP.** В.Г. Дейбук 10 1179
- Оптические и теплофизические свойства твердых растворов $CuAl_xIn_{1-x}Te_2$.** И.В. Боднарь 11 1285
- Влияние межзеренных границ раздела на свойства теллурида кадмия, полученного в неравновесных условиях.** В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков 11 1298
- Дефектообразование в решетке PbTe под воздействием лазерной ударной волны.** В.С. Яковина, Д.М. Заячук, Н.Н. Берченко 11 1313

4.1.1. Исследование структуры полупроводников (PACS 61.10-61.16)

- Слоистое строение пленок $Zn_{1-x}Cd_xSe$, выращенных газофазной эпитаксией из металлоорганических соединений на подложках $Cd_{0,92}Zn_{0,08}S$ (0001). В.П. Мартовицкий, В.И. Козловский, П.И. Кузнецов, Я.К. Скасырский, Г.Г. Якушева 3 310
- К вопросу о модификации поверхности кремния при ее исследовании методом сканирующей туннельной микроскопии. В.М. Корнилов, А.Н. Лачинов 3 323
- Трансформация параметров фазового перехода полупроводник–металл при кристаллизации аморфных пленок диоксида ванадия. В.А. Климов, И.О. Тимофеева, С.Д. Ханин, Е.Б. Шадрин, А.В. Ильинский, Ф. Сильва-Андрате 4 388
- Влияние резко неравновесных условий на стехиометрию состава слоя теллурида кадмия, конденсируемого из паровой фазы. А.П. Беляев, В.П. Рубец, М.Ю. Нуждин, И.П. Калинин 6 641
- Определение параметров многослойных наноструктур с помощью двухволновой рентгеновской рефлектометрии. Н.Л. Попов, Ю.А. Успенский, А.Г. Турьянский, И.В. Пиршин, А.В. Виноградов, Ю.Я. Платонов 6 700
- Электроннографическое исследование многоструктурности аморфных пленок полиморфного $TlInS_2$. Д.И. Исмаилов, М.В. Алиева, Э.Ш. Алекперов, Ф.И. Алиев 7 772
- К вопросу об исследовании композитов на основе нанопористого углерода методом малоуглового рентгеновского рассеяния. Э.А. Сморгонская 7 796
- Рентгенодифракционное исследование структуры нанопористого углерода, полученного из карбидных материалов. Р.Н. Кютт, А.М. Данишевский, Э.А. Сморгонская, С.К. Гордеев 7 811

4.1.2. Аморфные, стеклообразные полупроводники (PACS 61.43)

- Прозрачность макропористого кремния со сквозными каналами. Е.В. Астрова, Л.И. Коровин, И.Г. Ланг, А.Д. Ременюк, В.Б. Шуман 1 57
- Влияние заряженных дефектов на обнаружение электронного парамагнитного резонанса в стеклообразных халькогенидных полупроводниках. Л.П. Гинзбург 1 83
- Кинетика роста поверхностных аморфных слоев при облучении кремния легкими ионами низких энергий. А.И. Титов, А.Ю. Азаров, В.С. Беляков 3 358
- Структурное разупорядочение и соотношение Видемана–Франца в расплавах некоторых полупроводников типа $A^{IV}B^{IV}C_2^V$. Я.Б. Магомедов, М.А. Айдамиров 4 385
- Трансформация параметров фазового перехода полупроводник–металл при кристаллизации аморфных пленок диоксида ванадия. В.А. Климов, И.О. Тимофеева, С.Д. Ханин, Е.Б. Шадрин, А.В. Ильинский, Ф. Сильва-Андрате 4 388
- Модель многоостровковых одноэлектронных цепочек на основе метода Монте-Карло. И.И. Абрамов, С.А. Игнатенко, Е.Г. Новик 5 583

- Полуизолирующие слои карбида кремния, полученные диффузией ванадия в пористый $4H-SiC$. М.Г. Мынбаева, А.А. Лаврентьев, Н.И. Кузнецов, А.Н. Кузнецов, К.Д. Мынбаев, А.А. Лебедев 5 612
- Фазовые превращения, инициируемые в тонких слоях аморфного кремния наносекундным воздействием излучения эксимерного лазера. Г.Д. Ивлев, Е.И. Гацкевич 5 622
- Модификация наноструктуры алмазоподобных пленок углерода бомбардировкой ионами ксенона. И.А. Файзрахманов, В.В. Базаров, А.Л. Степанов, И.Б. Хайбуллин 6 748
- Влияние светового излучения на скорость релаксации фотоиндуцированных метастабильных состояний в $a-Si:H(B)$. И.А. Курова, Н.Н. Ормонт, А.Л. Громадин 6 753
- The influence of deposition conditions and alloying on the electronic properties of amorphous selenium. S.O. Kasap, K.V. Koughia, B. Fogal, G. Belev, R.E. Johanson 7 816
- Термическая стабильность и трансформация молекул C_{60} , нанесенных поверх пленки кремния на поверхность (111) иридия. Н.Р. Галль, Е.В. Рутьков, А.Я. Тонтегоде 9 1062
- Экстремальная дозовая зависимость концентрации парамагнитных центров, обусловленных оборванными связями в Si, при ионном облучении, как свидетельство наноструктурирования. Д.И. Тетельбаум, А.А. Ежевский, А.Н. Михайлов 11 1380

4.1.3. Кластеры и наночастицы (PACS 61.46)

- Фазово-структурные превращения в пленках SiO_x в процессе вакуумных термообработок. И.П. Лисовский, И.З. Индутный, Б.Н. Гненный, П.М. Литвин, Д.О. Мазунов, А.С. Оберемок, Н.В. Сопинский, П.Е. Шепелявый 1 98
- Оптические свойства фуллереносодержащих свободных пленок полидиметилфениленоксида. Ю.Ф. Бирюлин, Е.Ю. Меленевская, С.Н. Миков, С.Е. Орлов, В.Д. Петриков, Д.А. Сыкманов, В.Н. Згонник 1 110
- Синтез новых углерод-азотных нанокластеров при термическом отжиге в атмосфере азота алмазоподобных пленок углерода. И.А. Файзрахманов, В.В. Базаров, Н.В. Курбатова, И.Б. Хайбуллин, А.Л. Степанов 2 230
- Влияние термического отжига на оптические и фотоэлектрические свойства пленок микрокристаллического гидрированного кремния. А.Г. Казанский, Х. Мелл, П.А. Форш 2 235
- Спектры фотолюминесценции нанокристаллов кремния. Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, И.Р. Базылюк, С.В. Свечников 3 353
- Структура и оптические свойства пленок C_{60} на полимерных подложках. Ю.Ф. Бирюлин, В.Н. Згонник, Е.Ю. Меленевская, С.Н. Миков, С.С. Моливер, С.Е. Орлов, А.В. Новоселова, В.Д. Петриков, В.В. Розанов, Д.А. Сыкманов, М.А. Яговкина 3 365

- К вопросу об исследовании композитов на основе нанопористого углерода методом малоуглового рентгеновского рассеяния. Э.А. Сморгонская 7 796
- Фуллереновые микрокристаллы как адсорбенты органических соединений. В.И. Березкин, И.В. Викторовский, А.Я. Вуль, Л.В. Голубев, В.Н. Петрова, Л.О. Хорошко 7 802
- Рентгенодифракционное исследование структуры нанопористого углерода, полученного из карбидных материалов. Р.Н. Кютт, А.М. Данишевский, Э.А. Сморгонская, С.К. Гордеев 7 811
- Синхротронные исследования энергетического спектра электронов в наноструктурах на основе $A^{III}B^V$. Э.П. Домашевская, В.А. Терехов, В.М. Кашкаров, С.Ю. Турищев, С.Л. Молодцов, Д.В. Вялых, Д.А. Винокуров, В.П. Улин, С.Г. Конников, М.В. Шишков, И.Н. Арсентьев, И.С. Тарасов, Ж.И. Алфёров 8 1017
- Резонансное комбинационное рассеяние света в наноструктурах Ge, сформированных на подложке Si(111), покрытой ультратонким слоем SiO₂. В.А. Володин, М.Д. Ефремов, А.И. Никифоров, Д.А. Орехов, О.П. Пчеляков, В.В. Ульянов 10 1220
- 4.1.4. Дефекты в кристаллах (PACS 61.72)**
- Многочастотные кинки в многочастотных внешних полях. М.Е. Поляков 1 3
- Электрическая активность дислокаций и точечных дефектов деформационного происхождения в кристаллах Cd_xHg_{1-x}Te. С.Г. Гасан-заде, С.В. Старый, М.В. Стриха, Г.А. Шепельский 1 8
- Особенности дефектной структуры текстурированных слитков нелегированного CdTe, выращенных свободным ростом из газодинамического потока паров. Ю.В. Клевков, В.П. Мартовицкий, С.А. Медведев 2 129
- Фотоиндуцированный отжиг метастабильных дефектов в легированных бором пленках a-Si:H. И.А. Курова, Н.Н. Ормонг, А.Л. Громадин 2 142
- U-пик в спектрах DLTS n-GaAs, облученного быстрыми нейтронами и протонами (65 МэВ). В.Н. Брудный, В.В. Пешев 2 151
- Инверсия типа проводимости в монокристаллах ZnSe, полученных методом свободного роста. Ю.Ф. Ваксман, Ю.А. Ницук, Ю.Н. Пуртов, П.В. Шапкин 2 156
- Влияние термического отжига на оптические и фотоэлектрические свойства пленок микрокристаллического гидрированного кремния. А.Г. Казанский, Х. Мелл, П.А. Форш 2 235
- Влияние отжига в парах и в жидком Zn на фотолюминесценцию высокочистых поликристаллов ZnTe. В.С. Багаев, В.В. Зайцев, Ю.В. Клевков, В.С. Кривобок, Е.Е. Онищенко 3 299
- Влияние олова на реакции, протекающие с участием межзельного углерода в облученном кремнии. Л.И. Хируненко, О.А. Кобзарь, Ю.В. Помозов, М.Г. Соснин, Н.А. Трипачко 3 304
- Трансформация параметров фазового перехода полупроводник–металл при кристаллизации аморфных пленок диоксида ванадия. В.А. Климов, И.О. Тимофеева, С.Д. Ханин, Е.Б. Шадрин, А.В. Ильинский, Ф. Сильва-Андрате 4 388
- Уровни вакансий и межзельных атомов в запрещенной зоне кремния. В.В. Лукьяница 4 422
- Исследования влияния углерода на свойства гетероструктур Si/SiGe. М.Я. Валах, В.Н. Джаган, Л.А. Матвеева, А.С. Оберемок, Б.Н. Романюк, В.А. Юхимчук 4 460
- Особенности формирования и характеристики диодов Шоттки Ni/21R-SiC. В.Л. Литвинов, К.Д. Демаков, О.А. Агеев, А.М. Светличный, Р.В. Конакова, П.М. Литвин, О.С. Литвин, В.В. Миленин 4 473
- Искусственные подложки GeSi для гетероэпитаксии — достижения и проблемы. Ю.Б. Болховитянов, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов, С.И. Чикичев 5 513
- Релаксация дефектной подсистемы кремния, модифицированной облучением тяжелыми ионами высоких энергий. С.А. Смагулова, И.В. Антонова, Е.П. Неустроев, В.А. Скуратов 5 565
- Диффузия европия в кремнии. Д.Э. Назыров 5 570
- Квантово-химическое моделирование влияния дефектов на инфракрасный спектр и электронную структуру a-Se. А.С. Зюбин, Ф.В. Григорьев, С.А. Дембовский 5 616
- Влияние резко неравновесных условий на стехиометрию состава слоя теллурида кадмия, конденсируемого из паровой фазы. А.П. Беляев, В.П. Рубец, М.Ю. Нуждин, И.П. Калинин 6 641
- Модель ослабления диффузии, ускоренной окислением, в сильно легированных слоях кремния. О.В. Александров, Н.Н. Афонин 6 649
- Defect profiling in semiconductor layers by electrochemical method. Ákos Nemcsics, János P. Makai 6 657
- Электрические свойства пленок теллурида кадмия, синтезированных в тепловом поле градиента температуры. А.П. Беляев, В.П. Рубец, М.Ю. Нуждин 6 671
- Легирование магнием в молекулярно-пучковой эпитаксии нитрида галлия из активированного азота. А.А. Воробьев, В.В. Кораблев, С.Ю. Карпов 7 866
- Моделирование кинетики роста октаэдрических и пластинчатых кислородных преципитатов в кремнии. В.В. Светухин, А.Г. Гришин, О.В. Приходько 7 871
- Синхротронные исследования энергетического спектра электронов в наноструктурах на основе $A^{III}B^V$. Э.П. Домашевская, В.А. Терехов, В.М. Кашкаров, С.Ю. Турищев, С.Л. Молодцов, Д.В. Вялых, Д.А. Винокуров, В.П. Улин, С.Г. Конников, М.В. Шишков, И.Н. Арсентьев, И.С. Тарасов, Ж.И. Алфёров 8 1017
- Спектры микрофотолюминесценции теллурида кадмия, полученного в неравновесных условиях. В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков 9 1067
- Дефектная люминесценция пленок GaN:Zn, отожженных в высокочастотной плазме аммиака. Г.А. Сукач, В.В. Кидалов, А.И. Власенко, Е.П. Потапенко 11 1290
- Влияние межзеренных границ раздела на свойства теллурида кадмия, полученного в неравновесных условиях. В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков 11 1298
- Дефектообразование в решетке PbTe под воздействием лазерной ударной волны. В.С. Яковина, Д.М. Заячук, Н.Н. Берченко 11 1313

- Экстремальная дозовая зависимость концентрации парамагнитных центров, обусловленных оборванными связями в Si, при ионном облучении, как свидетельство наноструктурирования. Д.И. Тетельбаум, А.А. Ежевский, А.Н. Михайлов 11 1380
- 4.1.5. Физические эффекты, связанные с облучением. Радиационные дефекты (PACS 61.80)**
- Самоорганизация лазерноиндуцированных точечных дефектов на начальных стадиях неупругих фотодеформаций германия. С.В. Винценц, А.В. Зайцева, Г.С. Плотноков 2 134
- U-пик в спектрах DLTS n-GaAs, облученного быстрыми нейтронами и протонами (65 МэВ). В.Н. Брудный, В.В. Пешев 2 151
- Положение примесных атомов мышьяка в решетке РbТе. С.А. Немов, П.П. Серегин, С.М. Иркаев, Н.П. Серегин 3 279
- Влияние олова на реакции, протекающие с участием межзельного углерода в облученном кремнии. Л.И. Хируненко, О.А. Кобзарь, Ю.В. Помозов, М.Г. Соснин, Н.А. Трипачко 3 304
- Кинетика роста поверхностных аморфных слоев при облучении кремния легкими ионами низких энергий. А.И. Титов, А.Ю. Азаров, В.С. Беляков 3 358
- Электрофизические свойства InAs, облученного протонами. В.Н. Брудный, Н.Г. Колин, А.И. Потапов 4 408
- Влияние импульсного лазерного излучения на морфологию и фотоэлектрические свойства кристаллов InSb. В.А. Гнатюк, Е.С. Городниченко 4 414
- Уровни вакансий и межзельных атомов в запрещенной зоне кремния. В.В. Лукьяница 4 422
- Накопление заряда в диэлектрике и состояния на границах структур кремний-на-изоляторе при облучении электронами и γ -квантами. Д.В. Николаев, И.В. Антонова, О.В. Наумова, В.П. Попов, С.А. Смагулова 4 443
- Электронные свойства облученных полупроводников, модель закрепления уровня Ферми. В.Н. Брудный, С.Н. Гриняев, Н.Г. Колин 5 557
- Релаксация дефектной подсистемы кремния, модифицированной облучением тяжелыми ионами высоких энергий. С.А. Смагулова, И.В. Антонова, Е.П. Неустров, В.А. Скуратов 5 565
- Модификация наноструктуры алмазоподобных пленок углерода бомбардировкой ионами ксенона. И.А. Файзрахманов, В.В. Базаров, А.Л. Степанов, И.Б. Хайбуллин 6 748
- Влияние электронного облучения на оптические и фотоэлектрические свойства микрокристаллического гидрированного кремния. А.Г. Казанский, П.А. Форш, К.Ю. Хабарова, М.В. Чукичев 9 1100
- Модифицирование свойств $Hg_{1-x}Cd_xTe$ низкоэнергетичными ионами. К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский 10 1153
- Фотоосаждение металла в гетеропереходах с твердым электролитом. Случай гетеропереходов $CdSe-As_2S_3:Ag_x$ ($x = 0.9-2.4$). А.И. Стедун 10 1197
- Ультрафиолетовая люминесценция тонких пленок GaN, полученных методом радикало-лучевой геттерирующей эпитаксии на пористых подложках GaAs (111). В.В. Кидалов, Г.А. Сукач, А.С. Ревенко, Е.П. Потапенко 11 1303
- Гальваномагнитные эффекты в атомно-разупорядоченных соединениях $HgSe_{1-x}S_x$. А.Е. Карькин, В.В. Щенников, С.Е. Данилов, В.А. Арбузов, Б.Н. Гощицкий 11 1316
- Экстремальная дозовая зависимость концентрации парамагнитных центров, обусловленных оборванными связями в Si, при ионном облучении, как свидетельство наноструктурирования. Д.И. Тетельбаум, А.А. Ежевский, А.Н. Михайлов 11 1380
- 4.2. Механические и акустические свойства (PACS 62). Динамика решетки (PACS 63)**
- Определение констант деформационного потенциала n-Si, p-Si по концентрационному ангармонизму. А.А. Скворцов, О.В. Литвиненко, А.М. Орлов 1 17
- Свойства мелких D^- -центров в полярных полупроводниках. Н.И. Каширина, В.Д. Лахно, В.В. Сычев, М.К. Шейнкман 3 318
- Колебательные спектры сверхрешеток $(GaAs)_n(Ga_{1-x}Al_xAs)_m$ в модели Китинга. Е.Н. Прыкина, Ю.И. Полыгалов, А.В. Копытов 3 328
- Распространение неравновесных фононов в монокристаллическом ZnTe. Т.И. Галкина, А.Ю. Клоков, А.И. Шарков, Ю.В. Коростелин, В.В. Зайцев 5 539
- Релаксация нейтрального состояния марганца в арсениде галлия. В.Ф. Мастеров, К.Ф. Штельмах, В.П. Маслов, С.Б. Михрин, Б.Е. Саморуков 8 943
- Термодинамическая устойчивость эпитаксиальных пленок GaInSb, InAsSb, GaInP. В.Г. Дейбук 10 1179
- Резонансное комбинационное рассеяние света в наноструктурах Ge, сформированных на подложке Si(111), покрытой ультратонким слоем SiO₂. В.А. Володин, М.Д. Ефремов, А.И. Никифоров, Д.А. Орехов, О.П. Пчеляков, В.В. Ульянов 10 1220
- Модифицирование нанокластеров германия в кремнии под действием импульсного лазерного излучения. В.А. Володин, Е.И. Гацкевич, А.В. Двуреченский, М.Д. Ефремов, Г.Д. Ивлев, А.И. Никифоров, Д.А. Орехов, А.И. Якимов 11 1352
- 4.3. Фазовые равновесия и фазовые переходы (PACS 64)**
- Влияние моновакансий на ширину террас при сублимации с поверхности (111) алмазоподобного кристалла. А.В. Зверев, И.Г. Неизвестный, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая 6 674
- Характеристики многоостровковых одноэлектронных цепочек в зависимости от различных факторов. И.И. Абрамов, С.А. Игнатенко, Е.Г. Новик 10 1231
- 4.4. Термические свойства (PACS 65). Диффузия и теплопроводность (PACS 66)**
- Диффузия европия в кремнии. Д.Э. Назыров 5 570
- Влияние моновакансий на ширину террас при сублимации с поверхности (111) алмазоподобного кристалла. А.В. Зверев, И.Г. Неизвестный, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая 6 674
- Моделирование кинетики роста октаэдрических и пластинчатых кислородных преципитатов в кремнии. В.В. Светухин, А.Г. Гришин, О.В. Приходько 7 871

- Диффузия иттербия в кремнии. Д.Э. Назыров 9 1056
- Энергия миграции вакансий в кристаллах кремния *p*-типа. Т.А. Пагава, З.В. Башлейшвили 9 1058
- Термическая стабильность и трансформация молекул C_{60} , нанесенных поверх пленки кремния на поверхность (111) иридия. Н.Р. Галль, Е.В. Рутьков, А.Я. Тонтегоде 9 1062
- Термодинамическая устойчивость эпитаксиальных пленок GaInSb, InAsSb, GaInP. В.Г. Дейбук 10 1179
- Оптические и теплофизические свойства твердых растворов $CuAl_xIn_{1-x}Te_2$. И.В. Боднар 11 1285
- Модифицирование нанокластеров германия в кремнии под действием импульсного лазерного излучения. В.А. Володин, Е.И. Гацкевич, А.В. Двуреченский, М.Д. Ефремов, Г.Д. Ивлев, А.И. Никифоров, Д.А. Орехов, А.И. Якимов 11 1352
- 4.5. Структура поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 68)**
- Самоорганизация лазерноиндуцированных точечных дефектов на начальных стадиях неупругих фотодеформаций германия. С.В. Винценц, А.В. Зайцева, Г.С. Плотников 2 134
- Сегрегация индия при выращивании квантовых ям InGaAs/GaAs в условиях газофазной эпитаксии. Ю.Н. Дроздов, Н.В. Байдусь, Б.Н. Звонков, М.Н. Дроздов, О.И. Хрыкин, В.И. Шашкин 2 203
- Фотолюминесценция квантовых ям и квантовых точек германия в кремнии, полученных при низких температурах молекулярно-пучковой эпитаксии. Т.М. Бурбаев, В.А. Курбатов, А.О. Погосов, М.М. Рзаев, Н.Н. Сибельдин 2 216
- Слоистое строение пленок $Zn_{1-x}Cd_xSe$, выращенных газофазной эпитаксией из металлоорганических соединений на подложках $Cd_{0,92}Zn_{0,08}S$ (0001). В.П. Мартовицкий, В.И. Козловский, П.И. Кузнецов, Я.К. Скасырский, Г.Г. Якушева 3 310
- К вопросу о модификации поверхности кремния при ее исследовании методом сканирующей туннельной микроскопии. В.М. Корнилов, А.Н. Лачинов 3 323
- Колебательные спектры сверхрешеток $(GaAs)_n(Ga_{1-x}Al_xAs)_m$ в модели Китинга. Е.Н. Прыкина, Ю.И. Полягалов, А.В. Копытов . . . 3 328
- Исследования влияния углерода на свойства гетероструктур Si/SiGe. М.Я. Валах, В.Н. Джаган, Л.А. Матвеева, А.С. Оберемок, Б.Н. Романюк, В.А. Юхимчук 4 460
- Структурные и оптические свойства квантовых точек InAs в матрице AlGaAs. Д.С. Сизов, Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин, Н.К. Поляков, В.А. Егоров, А.А. Тонких, А.Е. Жуков, С.С. Михрин, А.П. Васильев, Ю.Г. Мусихин, А.Ф. Цацульников, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов 5 578
- Влияние резко неравновесных условий на стехиометрию состава слоя теллурида кадмия, конденсируемого из паровой фазы. А.П. Беляев, В.П. Рубец, М.Ю. Нуждин, И.П. Калинин 6 641
- Водородно-индуцированное скалывание в кремнии по заглубленному слою, сильно легированному бором. Д.В. Киранов, В.П. Попов, Л.Н. Сафронов, А.И. Никифоров, Р. Шольц 6 644
- Defect profiling in semiconductor layers by electrochemical method. Ákos Nemcsics, János P. Makai . . 6 657
- Влияние моновакансий на ширину террас при сублимации с поверхности (111) алмазоподобного кристалла. А.В. Зверев, И.Г. Неизвестный, Н.Л. Шварц, З.Ш. Яновицкая 6 674
- Визуализация зарощенных наноструктур GeSi в кремниевых структурах методом атомно-силовой микроскопии на сколах. М.С. Дунаевский, З.Ф. Красильник, Д.Н. Лобанов, А.В. Новиков, А.Н. Титков, R. Laiho 6 692
- Определение параметров многослойных наноструктур с помощью двухволновой рентгеновской рефлектометрии. Н.Л. Попов, Ю.А. Успенский, А.Г. Турьянский, И.В. Пиршин, А.В. Виноградов, Ю.Я. Платонов 6 700
- Легирование магнием в молекулярно-пучковой эпитаксии нитрида галлия из активированного азота. А.А. Воробьев, В.В. Кораблев, С.Ю. Карпов 7 866
- Моделирование кинетики роста октаэдрических и пластинчатых кислородных преципитатов в кремнии. В.В. Светухин, А.Г. Гришин, О.В. Приходько 7 871
- Управление параметрами массивов квантовых точек InAs–GaAs в режиме роста Странского–Крастанова. Н.А. Черкашин, М.В. Максимов, А.Г. Макаров, В.А. Шукин, В.М. Устинов, Н.В. Луковская, Ю.Г. Мусихин, Г.Э. Цырлин, Н.А. Берг, Ж.И. Алфёров, Н.Н. Леденцов, Д. Бимберг 7 890
- Химическая нитризация поверхности (100)GaAs: влияние на электрофизические характеристики Au–Ti/GaAs поверхностно-барьерных структур. Т.В. Львова, В.Л. Берковиц, М.С. Дунаевский, В.М. Лантратов, И.В. Макаренко, В.Л. Улин 8 955
- Свойства светодиодов, изготовленных на основе структур InAsSbP/InAsSb, выращенных методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений. Н.В. Зотова, С.С. Кижаяев, С.С. Молчанов, Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, Б.В. Пушный, Ю.П. Яковлев 8 980
- Термическая стабильность и трансформация молекул C_{60} , нанесенных поверх пленки кремния на поверхность (111) иридия. Н.Р. Галль, Е.В. Рутьков, А.Я. Тонтегоде 9 1062
- Метаморфные модулированно-легированные гетероструктуры InAlAs/InGaAs/InAlAs с высокой подвижностью электронов на подложках GaAs. Е.С. Семенова, А.Е. Жуков, А.П. Васильев, С.С. Михрин, А.Р. Ковш, В.М. Устинов, Ю.Г. Мусихин, С.А. Блохин, А.Г. Гладышев, Н.Н. Леденцов 9 1127
- Резонансное комбинационное рассеяние света в наноструктурах Ge, сформированных на подложке Si(111), покрытой ультратонким слоем SiO_2 . В.А. Володин, М.Д. Ефремов, А.И. Никифоров, Д.А. Орехов, О.П. Пчеляков, В.В. Ульянов 10 1220
- О влиянии реальной поверхности монокристаллического Si на низкочастотное внутреннее трение и поведение эффективного модуля сдвига. А.В. Олейнич-Лысюк, Н.П. Бешлей, И.М. Фодчук . 11 1337
- Флуктуации заряда на границе срачивания в структурах кремний-на-изоляторе. И.В. Антонова, В.А. Стучинский, О.В. Наумова, Д.В. Николаев, В.П. Попов 11 1341

- Кинетика начальной стадии халькогенидной пассивации полупроводников $A^{III}B^V$. В.Ф. Антюшин, А.В. Буданов, Д.С. Кухаренко, Д.А. Палишкин . . . 11 1349
- Оптические свойства сверхтонких внедрений соединения GaAsN в GaAs, полученных методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, А.Р. Ковш, И.П. Сошников, А.Ф. Цацульников, Н. Kirmse, W. Neumann, J.Y. Chi, J.S. Wang, L. Wei, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов . . 11 1363
- Самопроизвольное формирование периодической наноструктуры с модуляцией состава в пленках $Cd_xHg_{1-x}Te$. П.А. Бахтин, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, А.Ф. Кравченко, А.В. Латышев, Н.Н. Михайлов, И.В. Сабина, Ю.Г. Сидоров, М.В. Якушев 11 1369
- Перераспределение иттербия и кислорода при отжиге аморфизованных имплантацией слоев кремния. О.В. Александров, Ю.А. Николаев, Н.А. Соболев, R. Asomoza, Yu. Kudriavtsev, A. Villegas, A. Godines 12 1409
- Фотолюминесценция при комнатной температуре в диапазоне 1.5–1.6 мкм от наногетероструктур InGaAs/GaAs, выращенных при низкой температуре подложки. А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, В.Г. Талалаев, Б.В. Новиков, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, Ю.Б. Самсоненко, В.М. Устинов, N.D. Zakharov, P. Werner 12 1456
- 5. Электронная структура, электрические, магнитные и оптические свойства (PACS 70)**
- Классификация частот осцилляций Шубникова–де-Гааза в слоистых зарядово-упорядоченных кристаллах при наличии магнитного пробоя. П.В. Горский 2 166
- 5.1. Электронные состояния (PACS 71)**
- Определение констант деформационного потенциала n -Si, p -Si по концентрационному ангармонизму. А.А. Скворцов, О.В. Литвиненко, А.М. Орлов . . . 1 17
- Температурная зависимость зонной структуры политипов 3С, 2Н, 4Н и 6Н карбида кремния. С.М. Зубкова, Л.Н. Русина, Е.В. Смелянская 3 257
- Тонкая структура длинноволнового края экситон-фононного поглощения и гиперболические экситоны в карбиде кремния политипа 6Н. А.П. Крохмаль . . 3 266
- Полиамидиновые супрамолекулярные структуры — новый класс светочувствительных полимерных полупроводников. Е.Л. Александрова, М.М. Дудкина, А.В. Теньковцев 3 282
- Свойства мелких D^- -центров в полярных полупроводниках. Н.И. Каширина, В.Д. Лахно, В.В. Сычев, М.К. Шейнкман 3 318
- Полупроводниковые свойства $CrSi_2$ с деформированной решеткой. А.В. Кривошея, В.Л. Шапошников, А.Е. Кривошеев, А.Б. Филонов, В.Е. Борисенко . . . 4 402
- Магнитооптические осцилляции в висмуте при температурах $T \geq 77$ К. О.В. Кондаков, К.Г. Иванов 5 543
- Локальная особенность изменения спектра пикосекундной суперлюминесценции при дополнительной генерации носителей в нефермиевскую электронно-дырочную плазму в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневой, А.Н. Кривонос, С.Е. Кумеков, С.В. Стеганцов 5 546
- Структурные и оптические свойства квантовых точек InAs в матрице AlGaAs. Д.С. Сизов, Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин, Н.К. Поляков, В.А. Егоров, А.А. Тонких, А.Е. Жуков, С.С. Михрин, А.П. Васильев, Ю.Г. Мусихин, А.Ф. Цацульников, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов 5 578
- Квантово-химическое моделирование влияния дефектов на инфракрасный спектр и электронную структуру α -Se. А.С. Зюбин, Ф.В. Григорьев, С.А. Дембовский 5 616
- Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и рентгеновский микроанализ монокристаллов на основе теллурида висмута. И.В. Гасенкова, В.А. Чубаренко, Е.А. Тявловская, Т.Е. Свечникова . 6 661
- Неомическая проводимость при переходе от слабой к сильной локализации в структурах GaAs/InGaAs с двумерным электронным газом. А.А. Шерстобитов, Г.М. Миньков, О.Э. Рут, А.В. Германенко, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова, А.А. Бирюков 6 730
- III Международная конференция „Аморфные и микрокристаллические полупроводники“. Е. Терунок . 7 769
- Фундаментальные спектры оптических функций селенида бериллия. В.Вал. Соболев, В.В. Соболев . 7 779
- Оптические свойства дефектного селенида индия. В.Вал. Соболев, В.В. Соболев 7 784
- Синтез и физические свойства стекол в системах Si(Ge)—Se—Te. Л.А. Кулакова, Б.Т. Мелех, В.И. Бахарев, В.Х. Кудоярова 7 822
- Особенности электронного парамагнитного резонанса в 4H-SiC в области фазового перехода изолятор–металл. I. Эффекты спинового взаимодействия. А.И. Вейнгер, А.Г. Забродский, Т.В. Тиснек, Е.Н. Мохов 7 874
- Электронная структура кубического карбида кремния с 3d-примесями в Si- и C-позициях замещения. Н.И. Медведева, Э.И. Юрьева, А.Л. Ивановский . . 11 1281
- Оптические и теплофизические свойства твердых растворов $CuAl_xIn_{1-x}Te_2$. И.В. Боднар 11 1285
- Экситонная рекомбинация около края подвижности в CdSe/ZnSe-наноструктурах. М.Я. Валах, М.П. Лисица, В.В. Стрельчук, Н.В. Вуйчик, С.В. Иванов, А.А. Торопов, Т.В. Шубина, П.С. Копьев 11 1374
- Двухэлектронные центры олова, образующиеся в халькогенидах свинца в результате ядерных превращений. С.А. Немов, П.П. Серегин, Ю.В. Кожанова, Н.П. Серегин 12 1414
- 5.1.1. Уровни дефектов и примесей (PACS 71.55)**
- Влияние электронного (зарядового) состояния E -ловушек на эффективность их накопления в n -GaAs при облучении. В.Н. Брудный, В.В. Пешев 1 22
- Исследование фотоемкости диодов из кремния, легированного ванадием. Х.Т. Игамбердиев, А.Т. Мамадалимов, Р.А. Муминов, Т.А. Усманов, Ш.А. Шоюсупов 1 29

- Особенности дефектной структуры текстурированных слитков нелегированного CdTe, выращенных свободным ростом из газодинамического потока паров. Ю.В. Клевков, В.П. Мартовицкий, С.А. Медведев . 2 129
- U-пик в спектрах DLTS n-GaAs, облученного быстрыми нейтронами и протонами (65 МэВ). В.Н. Брудный, В.В. Пешев 2 151
- Особенности определения концентраций мелких примесей в полупроводниках из анализа спектров краевой люминесценции. К.Д. Глинчук, А.В. Прохорович 2 159
- Примесная зона в кристаллах Hg₃In₂Te₆, легированных кремнием. П.Н. Горлей, О.Г. Грушка 2 176
- Положение примесных атомов мышьяка в решетке РbTe. С.А. Немов, П.П. Серегин, С.М. Иркаев, Н.П. Серегин 3 279
- Кинетика роста поверхностных аморфных слоев при облучении кремния легкими ионами низких энергий. А.И. Титов, А.Ю. Азаров, В.С. Беляков 3 358
- Уровни вакансий и межузельных атомов в запрещенной зоне кремния. В.В. Лукьяница 4 422
- Исследования влияния углерода на свойства гетероструктур Si/SiGe. М.Я. Валах, В.Н. Джаган, Л.А. Матвеева, А.С. Оберемок, Б.Н. Романюк, В.А. Юхимчук 4 460
- Генерационно-рекомбинационные центры в CdTe:V. Л.А. Косяченко, С.Ю. Паранчич, Ю.В. Танасюк, В.М. Склярчук, Е.Ф. Склярчук, Е.Л. Масляничук, В.В. Мотушук 4 469
- Электронные свойства облученных полупроводников, модель закрепления уровня Ферми. В.Н. Брудный, С.Н. Гриняев, Н.Г. Колин 5 557
- Полуизолирующие слои карбида кремния, полученные диффузией ванадия в пористый 4H-SiC. М.Г. Мынбаева, А.А. Лаврентьев, Н.И. Кузнецов, А.Н. Кузнецов, К.Д. Мынбаев, А.А. Лебедев 5 612
- Квантово-химическое моделирование влияния дефектов на инфракрасный спектр и электронную структуру α-Se. А.С. Зюбин, Ф.В. Григорьев, С.А. Дембовский 5 616
- Обнаружение примеси водорода в кремниевых детекторах излучения. Л.Ф. Макаренко, Ф.П. Коршунов, С.Б. Ластовский, Н.И. Замятин 5 629
- Влияние светового излучения на скорость релаксации фотоиндуцированных метастабильных состояний в α-Si:H(B). И.А. Курова, Н.Н. Ормонт, А.Л. Громадин 6 753
- The influence of deposition conditions and alloying on the electronic properties of amorphous selenium. S.O. Kasap, K.V. Koughia, B. Fogal, G. Belev, R.E. Johanson 7 816
- Изучение влияния кислорода на интенсивность фотолюминесценции эрбия в пленках α-SiO₂:H(Er), полученных магнетронным способом. Ю.К. Ундалов, Е.И. Теруков, О.Б. Гусев, В.Х. Кудоярова 7 853
- Мессбауэровское исследование примесных атомов железа в арсениде галлия. П.П. Серегин, Т.Р. Степанова, Ю.В. Кожанова, В.П. Волков 8 917
- Редкоземельные элементы в технологии соединений A^{III}B^V и приборов на их основе. А.Т. Гореленок, А.В. Каманин, Н.М. Шмидт 8 922
- Влияние условий молекулярно-лучевой эпитаксии на захват кремния в подрешетки А и В арсенида галлия. И.А. Бобровникова, М.Д. Вилисова, И.В. Ивонин, Л.Г. Лаврентьева, В.В. Преображенский, М.А. Путято, Б.Р. Семягин, С.В. Субач, С.Е. Торопов 9 1072
- Электронная структура кубического карбида кремния с 3d-примесями в Si- и С-позициях замещения. Н.И. Медведева, Э.И. Юрьева, А.Л. Ивановский . . 11 1281
- Гальваномагнитные эффекты в атомно-разупорядоченных соединениях HgSe_{1-x}S_x. А.Е. Карькин, В.В. Щенников, С.Е. Данилов, В.А. Арбузов, Б.Н. Гощицкий 11 1316
- Двухэлектронные центры олова, образующиеся в халькогенидах свинца в результате ядерных превращений. С.А. Немов, П.П. Серегин, Ю.В. Кожанова, Н.П. Серегин 12 1414
- Особенности электропроводности монокристаллов Cd_{1-x}Zn_xTe и Cd_{1-x}Mn_xTe. Л.А. Косяченко, А.В. Марков, Е.Л. Масляничук, И.М. Раренко, В.М. Склярчук 12 1420

5.2. Транспортные явления (PACS 72)

- Электрическая активность дислокаций и точечных дефектов деформационного происхождения в кристаллах Cd_xHg_{1-x}Te. С.Г. Гасан-заде, С.В. Старый, М.В. Стриха, Г.А. Шепельский 1 8
- Аномалии статической и динамической проводимости моноселенида индия. Г.В. Лашкарев, А.И. Дмитриев, А.А. Байда, З.Д. Ковалюк, М.В. Кондрин, А.А. Пронин 2 145
- Инверсия типа проводимости в монокристаллах ZnSe, полученных методом свободного роста. Ю.Ф. Ваксман, Ю.А. Ницук, Ю.Н. Пуртов, П.В. Шапкин . . . 2 156
- Классификация частот осцилляций Шубникова-де-Гааза в слоистых зарядово-упорядоченных кристаллах при наличии магнитного пробоя. П.В. Горский 2 166
- Электрические свойства монокристаллов FeIn₂Se₄. Н.Н. Нифтиев, М.А. Алиджанов, О.Б. Тагиев, М.Б. Мурадов 2 173
- Влияние термического отжига на оптические и фотоэлектрические свойства пленок микрокристаллического гидрированного кремния. А.Г. Казанский, Х. Мелл, П.А. Форш 2 235
- Термоэлектрическая эффективность твердых растворов с рассеянием фононов на нецентральных примесях. Е.А. Гуриева, П.П. Константинов, Л.В. Прокофьева, Ю.И. Равич, М.И. Федоров 3 292
- Электропроводность одномерного полупроводника с периодическим потенциалом. С.Д. Бенеславский, А.А. Елистратов, С.В. Шибков 3 346
- Структурное разупорядочение и соотношение Видемана-Франца в расплавах некоторых полупроводников типа A^{II}B^{IV}C₂^V. Я.Б. Магомедов, М.А. Айдамиров 4 385
- Влияние внутренних полей на туннельный ток в напряженных структурах GaN/Al_xGa_{1-x}N(0001). С.Н. Гриняев, А.Н. Разжувалов 4 450

- Фоточувствительные структуры на монокристаллах CdGa_2Se_4 . А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius 5 572
- Электрические свойства пленок теллурида кадмия, синтезированных в тепловом поле градиента температуры. А.П. Беляев, В.П. Рубец, М.Ю. Нуждин . . 6 671
- Нулевые аномалии транспортных характеристик однобарьерных гетероструктур GaAs/AlAs/GaAs как проявление резонансного туннелирования между параллельными двумерными электронными газами и подавление резонансного туннелирования в магнитном поле как проявление кулоновской щели в туннельной плотности состояний. Ю.Н. Ханин, Ю.В. Дубровский, Е.Е. Вдовин 6 717
- Модификация наноструктуры алмазоподобных пленок углерода бомбардировкой ионами ксенона. И.А. Файзрахманов, В.В. Базаров, А.Л. Степанов, И.Б. Хайбуллин 6 748
- Влияние светового излучения на скорость релаксации фотоиндуцированных метастабильных состояний в $\alpha\text{-Si:H(B)}$. И.А. Курова, Н.Н. Ормонт, А.Л. Громадин 6 753
- III Международная конференция „Аморфные и микрокристаллические полупроводники“. Е. Теруков . 7 769
- Фотоиндуцированное изменение проводимости пленок аморфного гидрированного кремния, легированного эрбием. А.Г. Казанский, Х. Мелл, Е.И. Теруков, П.А. Форш 7 793
- Оптические и электрические свойства полиамидокислоты и металл-полимерного комплекса с Tb^{+2} на ее основе. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, М.Е. Компан, В.Х. Кудоярова, И.В. Подешво, Е.И. Теруков, В.В. Кудрявцев 7 844
- Оптические и светочувствительные свойства гребнеобразных полиамидоимидов. Е.Л. Александрова, М.Я. Гойхман, Л.И. Субботина, К.А. Ромашкова, И.Ф. Гофман, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский . . 7 849
- Взаимодействие носителей заряда с локализованными магнитными моментами марганца в гетероструктурах $p\text{-GaInAsSb}/p\text{-InAs:Mn}$. Т.С. Лагунова, Т.И. Воронина, М.П. Михайлова, К.Д. Моисеев, Е. Самохин, Ю.П. Яковлев 8 901
- Редкоземельные элементы в технологии соединений $\text{A}^{\text{III}}\text{B}^{\text{V}}$ и приборов на их основе. А.Т. Гореленок, А.В. Каманин, Н.М. Шмидт 8 922
- Влияние электронного облучения на оптические и фотоэлектрические свойства микрокристаллического гидрированного кремния. А.Г. Казанский, П.А. Форш, К.Ю. Хабарова, М.В. Чукичев 9 1100
- Модифицирование свойств $\text{Hg}_{1-x}\text{Cd}_x\text{Te}$ низкоэнергетичными ионами. К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский 10 1153
- Эффективная масса электронов в $\text{Mn}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$. И.М. Несмелова 11 1296
- Прыжковая поляризационная фотопроводимость кремния с участием пар примесей III и V групп. Я.Е. Покровский, Н.А. Хвальковский 11 1305
- Дефектообразование в решетке PbTe под воздействием лазерной ударной волны. В.С. Яковина, Д.М. Заячук, Н.Н. Берченко 11 1313
- Особенности электропроводности монокристаллов $\text{Cd}_{1-x}\text{Zn}_x\text{Te}$ и $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$. Л.А. Косяченко, А.В. Марков, Е.Л. Маслянчук, И.М. Раренко, В.М. Склярчук 12 1420
- Исследование границы раздела $\text{ZnS}-\text{CdHgTe}$. В.П. Бирюлин, С.А. Дудко, С.А. Коновалов, Ю.А. Пелевин, В.И. Туринов 12 1431
- Спиновая деполяризация в спонтанно поляризованных низкоразмерных системах. И.А. Шельх, Н.Т. Баграев, Л.Е. Клячкин 12 1438
- 5.2.1. Явления электронной проводимости в полупроводниках (PACS 72.20)**
- Электрическая активность дислокаций и точечных дефектов деформационного происхождения в кристаллах $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$. С.Г. Гасан-заде, С.В. Старый, М.В. Стриха, Г.А. Шепельский 1 8
- Исследование магниточувствительности транзисторных структур с диффузионным переносом инжектированных носителей. М.А. Глауберман, В.В. Егоров, В.В. Козел, Н.А. Канищева 1 32
- Туннельная рекомбинация в кремниевых лавинных диодах. С.В. Булярский, В.К. Ионычев, В.В. Кузьмин 1 117
- Аномалии статической и динамической проводимости моноселенида индия. Г.В. Лашкарев, А.И. Дмитриев, А.А. Байда, З.Д. Ковалюк, М.В. Кондрин, А.А. Пронин 2 145
- Об обработке экспериментальных данных по осцилляции магнитосопротивления в двумерном электронном газе. Н.С. Аверкиев, А.М. Монахов, Н.И. Саблина, Р.М. Коенгаад 2 169
- Электрические свойства монокристаллов FeIn_2Se_4 . Н.Н. Нифтиев, М.А. Алиджанов, О.Б. Тагиев, М.Б. Мурадов 2 173
- Примесная зона в кристаллах $\text{Hg}_3\text{In}_2\text{Te}_6$, легированных кремнием. П.Н. Горлей, О.Г. Грушка 2 176
- Эффект Рашбы в инверсионных и обогащенных слоях InAs . В.Ф. Раданцев, И.М. Иванкив, А.М. Яфясов . 2 209
- Термоэлектрическая эффективность твердых растворов с рассеянием фононов на нецентральных примесях. Е.А. Гуриева, П.П. Константинов, Л.В. Прокофьева, Ю.И. Равич, М.И. Федоров 3 292
- Особенности рассеяния электронов на гетерограницах $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{AlAs}(001)$. С.Н. Гриняев, Г.Ф. Каравасев, В.Н. Чернышов 4 435
- Дисперсия времени релаксации квазидвумерных электронов при рассеянии на ионах примеси в сверхрешетке с легированными квантовыми ямами. С.И. Борисенко 5 588
- Фотоэлектрические явления в монокристаллах CdV_2S_4 и структурах на их основе. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius 6 666
- Электрические свойства пленок теллурида кадмия, синтезированных в тепловом поле градиента температуры. А.П. Беляев, В.П. Рубец, М.Ю. Нуждин . . 6 671
- Взаимодействие носителей заряда с локализованными магнитными моментами марганца в гетероструктурах $p\text{-GaInAsSb}/p\text{-InAs:Mn}$. Т.С. Лагунова, Т.И. Воронина, М.П. Михайлова, К.Д. Моисеев, Е. Самохин, Ю.П. Яковлев 8 901

- Редкоземельные элементы в технологии соединенных $A^{III}B^V$ и приборов на их основе. А.Т. Гореленок, А.В. Каманин, Н.М. Шмидт 8 922
- О механизмах токопереноса в диодных структурах $Cr-p-InP$ и $Mo-p-InP$. С.В. Слободчиков, Х.М. Салихов, Б.Е. Саморуков 8 960
- Междолинное перераспределение электронов при низких температурах и магнитодиодный эффект. А.А. Абрамов, И.Н. Горбатый 9 1078
- Электрические и термоэлектрические свойства $p-Ag_2Te$ в β -фазе. Ф.Ф. Алиев 9 1082
- Явления коллективного поведения автосолитонов в диссипативной структуре в $InSb$. И.К. Камилов, А.А. Степуренко, А.С. Ковалев 9 1087
- О коэффициенте Нернста бинарных композитов в слабом магнитном поле. Б.Я. Балагуров 9 1094
- Рассеяние электронов на ионах примеси при низких температурах в сверхрешетке с легированными квантовыми ямами. С.И. Борисенко 9 1117
- Кинетика амбиполярных токов диффузии и дрейфа неравновесных носителей в полупроводниках. А.А. Абдуллаев, А.Р. Алиев, И.К. Камилов 10 1184
- Электронное поглощение поверхностных акустических волн квантовыми кольцами в магнитном поле. В.М. Ковалев, А.В. Чаплик 10 1225
- Гальваномагнитные эффекты в атомно-разупорядоченных соединениях $HgSe_{1-x}S_x$. А.Е. Карькин, В.В. Щенников, С.Е. Данилов, В.А. Арбузов, Б.Н. Гощицкий 11 1316
- 5.2.2. Высокочастотные эффекты и эффекты обусловленные плазмой (PACS 72.30)**
- Аномалии статической и динамической проводимости моноселенида индия. Г.В. Лашкарев, А.И. Дмитриев, А.А. Байда, З.Д. Ковалюк, М.В. Кондрин, А.А. Пронин 2 145
- Прыжковая поляризационная фотопроводимость кремния с участием пар примесей III и V групп. Я.Е. Покровский, Н.А. Хвальковский 11 1305
- 5.2.3. Фотопроводимость и фотовольтаический эффект (PACS 72.40)**
- Карбид-кремниевые транзисторные структуры как детекторы слабоионизирующего излучения. Н.Б. Строкан, А.М. Иванов, М.Е. Бойко, Н.С. Савкина, А.М. Стрельчук, А.А. Лебедев, Р. Якимова 1 65
- Создание и свойства фоточувствительных структур на монокристаллах $ZnIn_2S_4$. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius 2 187
- Формирование барьера в гетероструктуре (собственный оксид)- $p-InSe$. Электрические и фотоэлектрические свойства. С.И. Драпак, В.Б. Орлецкий, З.Д. Ковалюк, В.В. Нетьяга 2 196
- Влияние термического отжига на оптические и фотоэлектрические свойства пленок микрокристаллического гидрированного кремния. А.Г. Казанский, Х. Мелл, П.А. Форш 2 235
- Фотоэлектрические свойства пленок ZnO , легированных акцепторными примесями Cu и Ag . А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков, Е.Е. Якимов 3 275
- Влияние импульсного лазерного излучения на морфологию и фотоэлектрические свойства кристаллов $InSb$. В.А. Гнатюк, Е.С. Городниченко 4 414
- Фоточувствительные структуры на монокристаллах $ZnIn_2Se_4$. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 4 432
- Фоточувствительные структуры на монокристаллах $CdGa_2Se_4$. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius 5 572
- Фотоэлектрические явления в монокристаллах CdV_2S_4 и структурах на их основе. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius 6 666
- Спектральная фоточувствительность гетероструктур $a-SiGe:H/c-Si$. А.А. Шерченков 7 790
- Фотоиндуцированное изменение проводимости пленок аморфного гидрированного кремния, легированного эрбием. А.Г. Казанский, Х. Мелл, Е.И. Теруков, П.А. Форш 7 793
- Фоточувствительные структуры на монокристаллах фосфида бора. Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 8 947
- Влияние электронного облучения на оптические и фотоэлектрические свойства микрокристаллического гидрированного кремния. А.Г. Казанский, П.А. Форш, К.Ю. Хабарова, М.В. Чукичев 9 1100
- Кинетика амбиполярных токов диффузии и дрейфа неравновесных носителей в полупроводниках. А.А. Абдуллаев, А.Р. Алиев, И.К. Камилов 10 1184
- Фотоэлектрические явления в гетероструктурах $ZnO:Al-p-Si$. С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 11 1329
- 5.3. Электронная структура и электрические свойства поверхностей, границ раздела и тонких пленок (PACS 73)**
- Латеральный электронный транспорт в короткопериодных сверхрешетках $InAs/GaAs$ на пороге образования квантовых точек. В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунин, В.А. Рогозин, В.Г. Мокеров, Ю.В. Федоров, Ю.В. Хабаров, Е. Нарюми, К. Киндо, А. де Виссер 1 70
- Исследования электронных переходов в связанных квантовых ямах со встроенным электрическим полем методом спектроскопии фотоотражения. Г.Б. Галиев, В.Э. Каминский, В.Г. Мокеров, Л.П. Авакянц, П.Ю. Боков, А.В. Червяков, В.А. Кульбачинский 1 77
- Электрофизические свойства структур $Si:H/p-Si$, полученных имплантацией водорода. О.В. Наумова, И.В. Антонова, В.П. Попов, В.Ф. Стась 1 93
- Аномалии статической и динамической проводимости моноселенида индия. Г.В. Лашкарев, А.И. Дмитриев, А.А. Байда, З.Д. Ковалюк, М.В. Кондрин, А.А. Пронин 2 145

- Инверсия заселенности Г-подзон в квантовых ямах в условиях междолинного Г—L-переноса. В.Я. Алешкин, А.А. Андронов, А.А. Дубинов 2 224
- Структура энергетических квантовых уровней в квантовой точке, имеющей форму сплюснутого тела вращения. Г.Г. Зегря, О.В. Константинов, А.В. Матвеевцев 3 334
- Модель многоостровковых одноэлектронных цепочек на основе метода Монте-Карло. И.И. Абрамов, С.А. Игнатенко, Е.Г. Новик 5 583
- Дисперсия времени релаксации квазидвумерных электронов при рассеянии на ионах примеси в сверхрешетке с легированными квантовыми ямами. С.И. Борисенко 5 588
- О температурной зависимости статической электропроводности полупроводниковой квантовой проволоки в изоляторе. Н.А. Поклонский, Е.Ф. Кисляков, С.А. Вырко 6 735
- III Международная конференция „Аморфные и микрокристаллические полупроводники“. Е. Теруков . 7 769
- Оптические и светочувствительные свойства гребнеобразных полиамидоимидов. Е.Л. Александрова, М.Я. Гойхман, Л.И. Субботина, К.А. Ромашкова, И.Ф. Гофман, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский . . 7 849
- Электрические свойства и спектры люминесценции светодиодов на основе гетеропереходов InGaN/GaN с модулированно-легированными квантовыми ямами. С.С. Мамакин, А.Э. Юнович, А.Б. Ватгана, Ф.И. Маняхин 9 1131
- Модифицирование свойств Hg_{1-x}Cd_xTe низкоэнергетичными ионами. К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский 10 1153
- Переходный фототок и фотолюминесценция в пористом кремнии. Н.С. Аверкиев, Л.П. Казакова, Ю.П. Пирятинский, Н.Н. Смирнова 10 1244
- Экситонная рекомбинация около края подвижности в CdSe/ZnSe-наноструктурах. М.Я. Валах, М.П. Лисица, В.В. Стрельчук, Н.В. Вуйчик, С.В. Иванов, А.А. Торопов, Т.В. Шубина, П.С. Копьев 11 1374
- Спиновая деполаризация в спонтанно поляризованных низкоразмерных системах. И.А. Шелых, Н.Т. Баграев, Л.Е. Клячкин 12 1438
- GaInAsP/GaInP/AlGaInP-лазеры, излучающие на 780 нм, выращенные методом МОС-гидридной эпитаксии. Д.А. Винокуров, С.А. Зорина, В.А. Капитонов, А.Ю. Лешко, А.В. Лютетский, Д.Н. Николаев, Н.А. Пихтин, А.Л. Станкевич, Н.В. Фетисова, В.В. Шамахов, И.С. Тарасов 12 1473
- 5.3.1. Электронные состояния на поверхностях и границах раздела (PACS 73.20)**
- Латеральный электронный транспорт в короткопериодных сверхрешетках InAs/GaAs на пороге образования квантовых точек. В.А. Кульбачинский, Р.А. Луинин, В.А. Рогозин, В.Г. Мокеров, Ю.В. Федоров, Ю.В. Хабаров, Е. Нарюми, К. Киндо, А. де Виссер 1 70
- Влияние водородной плазмы на спектр электроотражения и спектр электронных состояний пористого кремния. Е.Ф. Венгер, Р.Ю. Голиней, Л.А. Матвеева, А.В. Васин 1 104
- Особенности электролюминесценции инжекционных лазеров на основе вертикально-связанных квантовых точек вблизи порога лазерной генерации. Н.Ю. Гордеев, С.В. Зайцев, Л.Я. Карачинский, В.И. Копчатов, И.И. Новиков, В.М. Устинов, П.С. Копьев 1 114
- Эффект Рашбы в инверсионных и обогащенных слоях InAs. В.Ф. Раданцев, И.М. Иванкив, А.М. Яфясов . 2 209
- Фотолюминесценция квантовых ям и квантовых точек германия в кремнии, полученных при низких температурах молекулярно-пучковой эпитаксии. Т.М. Бурбаев, В.А. Курбатов, А.О. Погосов, М.М. Рзаев, Н.Н. Сибельдин 2 216
- Инверсия заселенности Г-подзон в квантовых ямах в условиях междолинного Г—L-переноса. В.Я. Алешкин, А.А. Андронов, А.А. Дубинов 2 224
- Люминесценция квантовых точек ZnO, полученных с помощью синтетического опала. А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков, Г.А. Емельченко, И.А. Карпов, В.М. Масалов, Г.М. Михайлов, Е.Е. Якимов 3 330
- Электропроводность одномерного полупроводника с периодическим потенциалом. С.Д. Бенеславский, А.А. Елистратов, С.В. Шибков 3 346
- Спектры фотолюминесценции нанокристаллов кремния. Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, И.Р. Базылюк, С.В. Свечников 3 353
- Туннельная эмиссия электронов в фотополевых детекторах и в оже-транзисторе в сверхсильных электрических полях. В.Д. Калганов, Н.В. Милешкина, Е.В. Остроумова 3 372
- Транспорт в сверхрешетках со слабыми барьерами и проблема терагерцового блоховского генератора. А.А. Андронов, И.М. Нефедов, А.В. Соснин 3 378
- Свойства нанокристаллов Ge, сформированных имплантацией ионов Ge⁺ в пленки SiO₂ и последующим отжигом под гидростатическим давлением. И.Е. Тыщенко, А.Б. Талочкин, А.Г. Черков, К.С. Журавлев, А. Мисюк, М. Фельсков, В. Скорупа 4 479
- Электронные свойства облученных полупроводников, модель закрепления уровня Ферми. В.Н. Брудный, С.Н. Гриняев, Н.Г. Колин 5 557
- Структурные и оптические свойства квантовых точек InAs в матрице AlGaAs. Д.С. Сизов, Ю.Б. Самсонов, Г.Э. Цырлин, Н.К. Поляков, В.А. Егоров, А.А. Тонких, А.Е. Жуков, С.С. Михрин, А.П. Васильев, Ю.Г. Мусихин, А.Ф. Цацульников, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов 5 578
- Электронные и оптические свойства сверхрешеток AlAs/Al_xGa_{1-x}As (110). Г.Ф. Караваев, В.Н. Чернышов, Р.М. Егунов 5 592
- Фотолюминесцентные исследования двойных квантовых ям AlGaAs/GaAs/AlGaAs с тонким разделяющим AlAs-слоем. Г.Б. Галиев, М.В. Карачевцева, В.Г. Мокеров, В.А. Страхов, Г.Н. Шкердин, Н.Г. Яременко 5 599
- Разогрев электронов сильным продольным электрическим полем в квантовых ямах. Л.Е. Воробьев, С.Н. Данилов, В.Л. Зерова, Д.А. Фирсов 5 604
- Определение абсолютной величины поверхностного потенциала полупроводника по квазистатическим вольт-фарнадным характеристикам МДП структуры. А.Г. Ждан, Н.Ф. Кухарская, Г.В. Чучева 6 686

- Сверхизлучение в квантовых гетероструктурах. А.И. Климовская, Ю.А. Дрига, Е.Г. Гуле, О.А. Пикарук 6 706
- Исследование электронного транспорта в связанных квантовых ямах с двухсторонним легированием. Г.Б. Галиев, В.Э. Каминский, В.Г. Мокеров, В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунии, И.С. Васильевский, А.В. Деркач 6 711
- Нулевые аномалии транспортных характеристик однобарьерных гетероструктур GaAs/AlAs/GaAs как проявление резонансного туннелирования между параллельными двумерными электронными газами и подавление резонансного туннелирования в магнитном поле как проявление кулоновской щели в туннельной плотности состояний. Ю.Н. Ханин, Ю.В. Дубровский, Е.Е. Вдовин 6 717
- Низкотемпературная антистоксова фотолюминесценция в наноструктурах CdSe/ZnSe. М.Я. Валах, Н.В. Вуйчик, В.В. Стрельчук, С.В. Сорокин, Т.В. Шубина, С.В. Иванов, П.С. Копьев 6 724
- Неомическая проводимость при переходе от слабой к сильной локализации в структурах GaAs/InGaAs с двумерным электронным газом. А.А. Шерстобитов, Г.М. Миньков, О.Э. Рут, А.В. Германенко, Б.Н. Звонков, Е.А. Ускова, А.А. Бирюков 6 730
- Управление параметрами массивов квантовых точек InAs–GaAs в режиме роста Странского–Крастанова. Н.А. Черкашин, М.В. Максимов, А.Г. Макаров, В.А. Щукин, В.М. Устинов, Н.В. Луковская, Ю.Г. Мухихин, Г.Э. Цырлин, Н.А. Берт, Ж.И. Алфёров, Н.Н. Леденцов, Д. Бимберг 7 890
- Синхротронные исследования энергетического спектра электронов в наноструктурах на основе $A^{III}B^V$. Э.П. Домашевская, В.А. Терехов, В.М. Кашкаров, С.Ю. Турищев, С.Л. Молодцов, Д.В. Вялых, Д.А. Винокуров, В.П. Улин, С.Г. Конников, М.В. Шишков, И.Н. Арсентьев, И.С. Тарасов, Ж.И. Алфёров 8 1017
- Явления коллективного поведения автосолитонов в диссипативной структуре в InSb. И.К. Камиллов, А.А. Степуренко, А.С. Ковалев 9 1087
- Зависимость энергии активации $A(+)$ -центров от ширины квантовых ям в структурах GaAs/AlGaAs. Ю.Л. Иванов, П.В. Петров, А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, В.М. Устинов 9 1114
- Рассеяние электронов на ионах примеси при низких температурах в сверхрешетке с легированными квантовыми ямами. С.И. Борисенко 9 1117
- Метаморфные модулированно-легированные гетероструктуры InAlAs/InGaAs/InAlAs с высокой подвижностью электронов на подложках GaAs. Е.С. Семенова, А.Е. Жуков, А.П. Васильев, С.С. Михрин, А.Р. Ковш, В.М. Устинов, Ю.Г. Мухихин, С.А. Блохин, А.Г. Гладышев, Н.Н. Леденцов 9 1127
- Электронное поглощение поверхностных акустических волн квантовыми кольцами в магнитном поле. В.М. Ковалев, А.В. Чаплик 10 1225
- X^+ -трион в системе с пространственным разделением носителей заряда. Р.А. Сергеев, Р.А. Сурис 10 1235
- Переходный фототок и фотолюминесценция в пористом кремнии. Н.С. Аверкиев, Л.П. Казакова, Ю.П. Пирятинский, Н.Н. Смирнова 10 1244
- Электронный транспорт в униполярных гетероструктурных транзисторах с квантовыми точками в сильных электрических полях. В.Г. Мокеров, Ю.К. Пожела, Ю.В. Федоров 10 1248
- Кинетика начальной стадии халькогенидной пассивации полупроводников $A^{III}B^V$. В.Ф. Антюшин, А.В. Буданов, Д.С. Кухаренко, Д.А. Палишкин 11 1349
- Оптические свойства сверхтонких внедрений соединения GaAsN в GaAs, полученных методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, А.Р. Ковш, И.П. Сошников, А.Ф. Цацульников, Н. Kirmse, W. Neumann, J.Y. Chi, J.S. Wang, L. Wei, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов 11 1363
- Фотолюминесценция при комнатной температуре в диапазоне 1.5–1.6 мкм от наногетероструктур InGaAs/GaAs, выращенных при низкой температуре подложки. А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, В.Г. Талалаев, Б.В. Новиков, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, Ю.Б. Самсоненко, В.М. Устинов, N.D. Zakharov, P. Werner 12 1456
- GaInAsP/GaInP/AlGaInP-лазеры, излучающие на 780 нм, выращенные методом МОС-гибридной эпитаксии. Д.А. Винокуров, С.А. Зорина, В.А. Капитонов, А.Ю. Лешко, А.В. Лютецкий, Д.Н. Николаев, Н.А. Пихтин, А.Л. Станкевич, Н.В. Фетисова, В.В. Шамахов, И.С. Тарасов 12 1473
- 5.3.2. Барьеры Шоттки (PACS 73.30)**
- Электрические свойства изотипной гетероструктуры $p^+-Bi_2Te_3-p-GaSe$. С.И. Драпак, В.А. Манассон, В.В. Нетяга, З.Д. Ковалюк 2 180
- Токперенос в диодных структурах Fe–p-InP. С.В. Слободчиков, Х.М. Салихов, Б.Е. Саморуков 2 192
- Формирование барьера в гетероструктуре (собственный окисел)–p-InSe. Электрические и фотоэлектрические свойства. С.И. Драпак, В.Б. Орлецкий, З.Д. Ковалюк, В.В. Нетяга 2 196
- Электрические свойства поверхностно-барьерных диодов на основе CdZnTe. Л.А. Косяченко, И.М. Раренко, З.И. Захарчук, В.М. Склярчук, Е.Ф. Склярчук, И.В. Солончук, И.С. Кабанова, Е.Л. Масляничук 2 238
- Генерационно-рекомбинационные центры в CdTe:V. Л.А. Косяченко, С.Ю. Паранчич, Ю.В. Танасюк, В.М. Склярчук, Е.Ф. Склярчук, Е.Л. Масляничук, В.В. Мотушук 4 469
- Особенности формирования и характеристики диодов Шоттки Ni/21R-SiC. В.Л. Литвинов, К.Д. Демаков, О.А. Агеев, А.М. Светличный, Р.В. Конакова, П.М. Литвин, О.С. Литвин, В.В. Миленин 4 473
- Электронные свойства облученных полупроводников, модель закрепления уровня Ферми. В.Н. Брудный, С.Н. Гриняев, Н.Г. Колин 5 557
- Получение и свойства монокристаллов ZnFe₂S₄ и структур на их основе. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius 6 681
- Определение абсолютной величины поверхностного потенциала полупроводника по квазистатическим вольт-фарадным характеристикам МДП структуры. А.Г. Ждан, Н.Ф. Кухарская, Г.В. Чучева 6 686

- О механизмах токопереноса в диодных структурах Cr-*n*-InP и Mo-*n*-InP.** С.В. Слободчиков, Х.М. Салихов, Б.Е. Саморуков 8 960
- Фотоприемники ультрафиолетового излучения на основе структур металл-широкозонный полупроводник.** Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг, Е.В. Калинина, О.В. Константинов, Е.А. Поссе 8 968
- Влияние облучения быстрыми нейтронами на электрические характеристики приборов на основе CVD эпитаксиальных слоев 4H-SiC.** Е.В. Калинина, Г.Ф. Холуянов, Д.В. Давыдов, А.М. Стрельчук, А. Hallén, А.О. Константинов, В.В. Лучинин, А.Ю. Никифоров 10 1260
- Фоточувствительные структуры на монокристаллах CdGa₂S₄.** В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, А.А. Вайполин, И.В. Боднар, N. Fernelius 11 1321
- Флуктуации заряда на границе срачивания в структурах кремний-на-изоляторе.** И.В. Антонова, В.А. Стучинский, О.В. Наумова, Д.В. Николаев, В.П. Попов 11 1341
- Фоточувствительные структуры на кристаллах In₂S₃.** И.В. Боднар, В.А. Полубок, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь 11 1346
- 5.3.3. Транспортные явления в структурах, содержащих границы раздела (PACS 73.40)**
- Исследование фотоемкости диодов из кремния, легированного ванадием.** Х.Т. Игамбердиев, А.Т. Мамадалимов, Р.А. Муминов, Т.А. Усманов, Ш.А. Шоюсупов 1 29
- Шумовые характеристики кремниевых *p-n*-структур с тонкой областью умножения при термическом отжиге радиационных дефектов.** О.К. Барановский, П.В. Кучинский, Е.Д. Савенок 1 50
- Латеральный электронный транспорт в короткопериодных сверхрешетках InAs/GaAs на пороге образования квантовых точек.** В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунин, В.А. Рогозин, В.Г. Мокеров, Ю.В. Федоров, Ю.В. Хабаров, Е. Нарюми, К. Киндо, А. де Виссер 1 70
- Электрофизические свойства структур Si:H/*p*-Si, полученных имплантацией водорода.** О.В. Наумова, И.В. Антонова, В.П. Попов, В.Ф. Стась 1 93
- Электрические свойства изотипной гетероструктуры *p*⁺-Bi₂Te₃-*p*-GaSe.** С.И. Драпак, В.А. Манассон, В.В. Нетяга, З.Д. Ковалюк 2 180
- Формирование барьера в гетероструктуре (собственный оксид)-*p*-InSe.** Электрические и фотоэлектрические свойства. С.И. Драпак, В.Б. Орлецкий, З.Д. Ковалюк, В.В. Нетяга 2 196
- Инверсия заселенности Г-подзон в квантовых ямах в условиях междолинного Г-L-переноса.** В.Я. Алешкин, А.А. Андронов, А.А. Дубинов 2 224
- Электропроводность одномерного полупроводника с периодическим потенциалом.** С.Д. Бенеславский, А.А. Елистратов, С.В. Шибков 3 346
- Туннельная эмиссия электронов в фотополевых детекторах и в оже-транзисторе в сверхсильных электрических полях.** В.Д. Калганов, Н.В. Милешкина, Е.В. Остроумова 3 372
- Особенности рассеяния электронов на гетерограницах Al_xGa_{1-x}As/AlAs(001).** С.Н. Гриняев, Г.Ф. Каравасев, В.Н. Чернышов 4 435
- Накопление заряда в диэлектрике и состояния на границах структур кремний-на-изоляторе при облучении электронами и γ -квантами.** Д.В. Николаев, И.В. Антонова, О.В. Наумова, В.П. Попов, С.А. Смагулова 4 443
- Влияние внутренних полей на туннельный ток в напряженных структурах GaN/Al_xGa_{1-x}N(0001).** С.Н. Гриняев, А.Н. Разжувалов 4 450
- Характеристики арсенидгаллиевых структур и приборов Ганна на их основе, изготовленных с применением радиационно-термической технологии.** М.В. Ардышев, В.М. Ардышев 4 456
- Электролитический способ приготовления источника кремния с использованием внутреннего источника тока.** Д.Н. Горячев, Л.В. Беляков, О.М. Сресели 4 494
- 3С-SiC *p-n*-структуры, полученные методом сублимации на основе подложек 6H-SiC.** А.А. Лебедев, А.М. Стрельчук, Д.В. Давыдов, Н.С. Савкина, А.С. Трегубова, А.Н. Кузнецов, В.А. Соловьев, Н.К. Полетаев 4 499
- Электронные свойства облученных полупроводников, модель закрепления уровня Ферми.** В.Н. Брудный, С.Н. Гриняев, Н.Г. Колин 5 557
- Получение и свойства монокристаллов ZnFe₂S₄ и структур на их основе.** А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius 6 681
- Определение абсолютной величины поверхностного потенциала полупроводника по квазистатическим вольт-фарадным характеристикам МДП структуры.** А.Г. Ждан, Н.Ф. Кухарская, Г.В. Чучева 6 686
- Исследование электронного транспорта в связанных квантовых ямах с двухсторонним легированием.** Г.Б. Галиев, В.Э. Каминский, В.Г. Мокеров, В.А. Кульбачинский, Р.А. Лунин, И.С. Васильевский, А.В. Деркач 6 711
- Нулевые аномалии транспортных характеристик однопобарьерных гетероструктур GaAs/AlAs/GaAs как проявление резонансного туннелирования между параллельными двумерными электронными газами и подавление резонансного туннелирования в магнитном поле как проявление кулоновской щели в туннельной плотности состояний.** Ю.Н. Ханин, Ю.В. Дубровский, Е.Е. Вдовин 6 717
- Спектральная фоточувствительность гетероструктур *a*-SiGe:H/*c*-Si.** А.А. Шерченков 7 790
- Взаимодействие носителей заряда с локализованными магнитными моментами марганца в гетероструктурах *p*-GaInAsSb/*p*-InAs:Mn.** Т.С. Лагунова, Т.И. Воронина, М.П. Михайлова, К.Д. Моисеев, Е. Самохин, Ю.П. Яковлев 8 901
- Фоточувствительные структуры на монокристаллах фосфида бора.** Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 8 947
- Отрицательная люминесценция на длине волны 3.9 мкм в диодах на основе InGaAsSb.** М. Айдаралиев, Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, М.А. Ременный, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин 8 951

- Химическая нитризация поверхности (100)GaAs: влияние на электрофизические характеристики Au-Ti/GaAs поверхностно-барьерных структур. Т.В. Львова, В.Л. Берковиц, М.С. Дунаевский, В.М. Лантратов, И.В. Макаренко, В.П. Улин 8 955
- О** механизмах токопереноса в диодных структурах Cr-*n*-InP и Mo-*n*-InP. С.В. Слободчиков, Х.М. Салихов, Б.Е. Саморуков 8 960
- Умножение носителей заряда в кремниевых *P-N*-переходах. Ю.Н. Сережкин, А.А. Шестеркина 9 1109
- Рассеяние электронов на ионах примеси при низких температурах в сверхрешетке с легированными квантовыми ямами. С.И. Борисенко 9 1117
- Модифицирование свойств Hg_{1-x}Cd_xTe низкоэнергетичными ионами. К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский 10 1153
- Фотоосаждение металла в гетеропереходах с твердым электролитом. Случай гетеропереходов CdSe-As₂S₃:Ag_x (*x* = 0.9–2.4). А.И. Стецун . . . 10 1197
- Электронный транспорт в униполярных гетероструктурных транзисторах с квантовыми точками в сильных электрических полях. В.Г. Мокеров, Ю.К. Пожела, Ю.В. Федоров 10 1248
- Влияние облучения быстрыми нейтронами на электрические характеристики приборов на основе CVD эпитаксиальных слоев 4H-SiC. Е.В. Калинина, Г.Ф. Холуянов, Д.В. Давыдов, А.М. Стрельчук, А. Hallén, А.О. Константинов, В.В. Лучинин, А.Ю. Никифоров 10 1260
- Фоточувствительные структуры на монокристаллах CdGa₂S₄. В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, А.А. Вайполин, И.В. Боднар, N. Fernelius 11 1321
- Фотоэлектрические явления в гетероструктурах ZnO:Al-*p*-Si. С.Е. Никитин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 11 1329
- Термоэде полупроводникового *p-n*-гетероперехода. М.М. Гаджалиев, З.Ш. Пирмагомедов 11 1334
- Фоточувствительные структуры на кристаллах In₂S₃. И.В. Боднар, В.А. Полубок, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь 11 1346
- Исследование границы раздела ZnS-CdHgTe. В.П. Бирюлин, С.А. Дудко, С.А. Коновалов, Ю.А. Пелевин, В.И. Турнинов 12 1431
- Механизмы формирования фототока в гетеропереходах In₂O₃-InSe. В.П. Махний, А.И. Янчук 12 1435
- 5.3.4. Транспортные явления в тонких пленках (PACS 73.50)**
- Фотоэлектрические свойства пленок ZnO, легированных акцепторными примесями Cu и Ag. А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков, Е.Е. Якимов 3 275
- Туннельная эмиссия электронов в фотополевых детекторах и в оже-транзисторе в сверхсильных электрических полях. В.Д. Калганов, Н.В. Милешкина, Е.В. Остроумова 3 372
- Рекомбинационная неустойчивость тока в эпитаксиальных *p⁺-n*-структурах с локально введенными в *n*-область примесными атомами и определение параметров глубоких центров на ее основе. Б.С. Муравский, О.Н. Куликов, В.Н. Черный 4 393
- Фоточувствительные структуры на монокристаллах ZnIn₂Se₄. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 4 432
- Разогрев электронов сильным продольным электрическим полем в квантовых ямах. Л.Е. Воробьев, С.Н. Данилов, В.Л. Зерова, Д.А. Фирсов 5 604
- Получение и свойства монокристаллов ZnFe₂S₄ и структур на их основе. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius 6 681
- Спектральная фоточувствительность гетероструктур *a*-SiGe: H/*c*-Si. А.А. Шерченков 7 790
- Метаморфные модулированно-легированные гетероструктуры InAlAs/InGaAs/InAlAs с высокой подвижностью электронов на подложках GaAs. Е.С. Семенова, А.Е. Жуков, А.П. Васильев, С.С. Мхрин, А.Р. Ковш, В.М. Устинов, Ю.Г. Мусихин, С.А. Блохин, А.Г. Гладышев, Н.Н. Леденцов 9 1127
- Модифицирование свойств Hg_{1-x}Cd_xTe низкоэнергетичными ионами. К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский 10 1153
- Переходный фототок и фотолюминесценция в пористом кремнии. Н.С. Аверкиев, Л.П. Казакова, Ю.П. Пирятинский, Н.Н. Смирнова 10 1244
- Термоэде полупроводникового *p-n*-гетероперехода. М.М. Гаджалиев, З.Ш. Пирмагомедов 11 1334
- Самопроизвольное формирование периодической наноструктуры с модуляцией состава в пленках Cd_xHg_{1-x}Te. П.А. Бахтин, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, А.Ф. Кравченко, А.В. Латышев, Н.Н. Михайлов, И.В. Сабинаина, Ю.Г. Сидоров, М.В. Якушев 11 1369
- Механизмы формирования фототока в гетеропереходах In₂O₃-InSe. В.П. Махний, А.И. Янчук 12 1435
- 5.4. Сверхпроводимость (PACS 74). Магнитные свойства (PACS 75), магнитные резонансы (PACS 76)**
- Влияние заряженных дефектов на обнаружение электронного парамагнитного резонанса в стеклообразных халькогенидных полупроводниках. Л.П. Гинзбург 1 83
- Влияние перехода порядок-беспорядок в электронной подсистеме кристалла на электронную плотность в узлах решетки. Н.П. Серегин, Т.Р. Степанова, Ю.В. Кожанова, В.П. Волков, П.П. Серегин, Н.Н. Троицкая 7 830
- Особенности электронного парамагнитного резонанса в 4H-SiC в области фазового перехода изолятор-металл. I. Эффекты спинового взаимодействия. А.И. Вейнгер, А.Г. Забродский, Т.В. Тиснек, Е.Н. Мохов 7 874
- Взаимодействие носителей заряда с локализованными магнитными моментами марганца в гетероструктурах *p*-GaInAsSb/*p*-InAs: Mn. Т.С. Лагунова, Т.И. Воронина, М.П. Михайлова, К.Д. Моисеев, Е. Самохин, Ю.П. Яковлев 8 901
- ЭПР взаимодействующих центров марганца в арсениде галлия. К.Ф. Штельмах, М.П. Коробков, И.Г. Озеров 8 913

- Мессбауэровское исследование примесных атомов железа в арсениде галлия. П.П. Серегин, Т.Р. Степанова, Ю.В. Кожанова, В.П. Волков 8 917
- Электромагнитный эффект в высокотемпературной сверхпроводимости. А.В. Приходько 8 941
- Релаксация нейтрального состояния марганца в арсениде галлия. В.Ф. Мастеров, К.Ф. Штельмах, В.П. Маслов, С.Б. Михрин, Б.Е. Саморуков 8 943
- Синхротронные исследования энергетического спектра электронов в наноструктурах на основе $A^{III}B^V$. Э.П. Домашевская, В.А. Терехов, В.М. Кашкаров, С.Ю. Турищев, С.Л. Молодцов, Д.В. Вялых, Д.А. Винокуров, В.П. Улин, С.Г. Конников, М.В. Шишков, И.Н. Арсентьев, И.С. Тарасов, Ж.И. Алфёров 8 1017
- Локальная симметрия и электронная структура атомов олова в решетках $(Pb_{1-x}Sn_x)_{1-z}In_zTe$. С.А. Немов, Ю.В. Кожанова, П.П. Серегин, Н.П. Серегин, Д.В. Шамшур 9 1085
- Экстремальная дозовая зависимость концентрации парамагнитных центров, обусловленных оборванными связями в Si, при ионном облучении, как свидетельство наноструктурирования. Д.И. Тетельбаум, А.А. Ежеский, А.Н. Михайлов 11 1380
- Двухэлектронные центры олова, образующиеся в халькогенидах свинца в результате ядерных превращений. С.А. Немов, П.П. Серегин, Ю.В. Кожанова, Н.П. Серегин 12 1414
- 5.5. Диэлектрические и пьезоэлектрические свойства (PACS 77)**
- Полупроводниковые свойства $CrSi_2$ с деформированной решеткой. А.В. Кривошеева, В.Л. Шапошников, А.Е. Кривошеев, А.Б. Филонов, В.Е. Борисенко 4 402
- Фотолюминесценция аморфного углерода, выращенного лазерной абляцией графита. С.Г. Ястребов, В.И. Иванов-Омский, А. Рихтер 10 1193
- 5.6. Оптические свойства полупроводников, спектроскопия, взаимодействие с различными видами излучений (PACS 78)**
- Исследования электронных переходов в связанных квантовых ямах со встроенным электрическим полем методом спектроскопии фотоотражения. Г.Б. Галиев, В.Э. Каминский, В.Г. Мокеров, Л.П. Авакянц, П.Ю. Боков, А.В. Червяков, В.А. Кульбачинский 1 77
- Исследование оптических свойств структур со сверхплотными массивами квантовых точек Ge в матрице Si. А.Г. Макаров, Н.Н. Леденцов, А.Ф. Цацульников, Г.Э. Цырлин, В.А. Егоров, В.М. Устинов, Н.Д. Захаров, Р. Werner 2 219
- Влияние примеси гадолиния на прозрачность и отражательную способность кристаллов $Hg_3In_2Te_6$. П.М. Горлей, О.Г. Грушка, З.М. Грушка 3 272
- Исследования физических явлений в полупроводниковых наноструктурах с использованием планарно-неоднородных слоев. 1. Фотолюминесценция. Ю.В. Хабаров 3 339
- Тепловая и токовая перестройка длины волны излучения квантово-размерных лазеров диапазона 2.0–2.4 мкм. А.П. Астахова, А.Н. Баранов, А. Висе, А.Н. Именков, Н.М. Колчанова, Н.Д. Стоянов, А. Черняев, Д.А. Яреха, Ю.П. Яковлев 4 502
- Локальная особенность изменения спектра пикосекундной суперлюминесценции при дополнительной генерации носителей в нефермиевскую электронно-дырочную плазму в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневой, А.Н. Кривоносос, С.Е. Кумеков, С.В. Стеганцов 5 546
- Релаксация дефектной подсистемы кремния, модифицированной облучением тяжелыми ионами высоких энергий. С.А. Смагулова, И.В. Антонова, Е.П. Неустроев, В.А. Скуратов 5 565
- Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и рентгеновский микроанализ монокристаллов на основе теллурида висмута. И.В. Гасенкова, В.А. Чубаренко, Е.А. Тявловская, Т.Е. Свечникова 6 661
- Влияние имплантации ионов Р на фотолюминесценцию нанокристаллов Si в слоях SiO_2 . Г.А. Качурин, С.Г. Яновская, Д.И. Тетельбаум, А.Н. Михайлов 6 738
- Межзонное поглощение света в полупроводниковых наноструктурах. С.И. Покутний 6 743
- Оптические и светочувствительные свойства гребнеобразных полиамидоимидов. Е.Л. Александрова, М.Я. Гойхман, Л.И. Субботина, К.А. Ромашкова, И.Ф. Гофман, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский 7 849
- Рамановская и инфракрасная спектроскопии нанокристаллов GaN, выращенных хлорид-гидридной эпитаксией на оксидированном кремнии. В.Н. Бессолов, Ю.В. Жилиев, Е.В. Коненкова, В.А. Федирко, D.R.T. Zahn 8 964
- Метаморфные лазеры спектрального диапазона 1.3 мкм, выращенные методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложках GaAs. А.Е. Жуков, А.Р. Ковш, С.С. Михрин, Е.С. Семенова, Н.А. Малесев, А.П. Васильев, Е.В. Никитина, Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, Ю.М. Шерняков, Ю.Г. Мусихин, М.В. Максимов, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, Ж.И. Алфёров 9 1143
- Фотоосаждение металла в гетеропереходах с твердым электролитом. Случай гетеропереходов $CdSe-As_2S_3:Ag_x$ ($x = 0.9-2.4$). А.И. Стецун 10 1197
- Спектральная эллипсометрия аморфного гидрогенизированного углерода, выращенного при магнетронном распылении графита. С.Г. Ястребов, М. Гаррига, М.И. Алонсо, В.И. Иванов-Омский 10 1241
- Переходный фототок и фотолюминесценция в пористом кремнии. Н.С. Аверкиев, Л.П. Казакова, Ю.П. Пирятинский, Н.Н. Смирнова 10 1244
- Фотолюминесценция нанокластеров сульфида кадмия, сформированных в матрице пленки Ленгмюра-Блоджетт. Е.А. Багаев, К.С. Журавлев, Л.Л. Свешникова, И.А. Бадмаева, С.М. Репинский, М. Voelskow 11 1358
- Фотонные кристаллы на основе композитов опал-GaP и опал-GaPN: получение и оптические свойства. Г.М. Гаджиев, В.Г. Голубев, М.В. Заморянская, Д.А. Курдюков, А.В. Медведев, J. Merz, A. Mintairov, А.Б. Певцов, А.В. Селькин, В.В. Травников, Н.В. Шаренкова 12 1449

- Фотолюминесценция при комнатной температуре в диапазоне 1.5–1.6 мкм от наногетероструктур InGaAs/GaAs, выращенных при низкой температуре подложки. А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, В.Г. Талалаев, Б.В. Новиков, В.А. Егоров, Н.К. Поляков, Ю.Б. Самсоненко, В.М. Устинов, N.D. Zakharov, P. Werner 12 1456
- Лазерная генерация на длине волны 1.5 мкм в структурах с квантовыми точками на подложках GaAs. А.Е. Жуков, А.П. Васильев, А.Р. Ковш, С.С. Михрин, Е.С. Семенова, А.Ю. Егоров, В.А. Одноблюдов, Н.А. Малеев, Е.В. Никитина, Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, Ю.М. Шерняков, М.В. Максимов, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, Ж.И. Алфёров 12 1461
- 5.6.1. Оптические свойства объемных материалов (PACS 78.20)**
- Исследование фотоемкости диодов из кремния, легированного ванадием. Х.Т. Игамбердиев, А.Т. Мамадалимов, Р.А. Муминов, Т.А. Усманов, Ш.А. Шоюсупов 1 29
- Прозрачность макропористого кремния со сквозными каналами. Е.В. Астрова, Л.И. Коровин, И.Г. Ланг, А.Д. Ременюк, В.Б. Шуман 1 57
- Тонкая структура длинноволнового края экситон-фононного поглощения и гиперболические экситоны в карбиде кремния политипа 6H. А.П. Крохмаль 3 266
- Влияние примеси гадолиния на прозрачность и отражательную способность кристаллов Hg₃In₂Te₆. П.М. Горлей, О.Г. Грушка, З.М. Грушка 3 272
- Оптическое отражение в твердых растворах (Pb_{0.78}Sn_{0.22})_{1-x}In_xTe с высоким содержанием индия. А.Н. Вейс, А.В. Нащекин 4 398
- Двулучепреломление инфракрасного света в искусственном кристалле, полученном с помощью анизотропного травления кремния. Е.В. Астрова, T.S. Perova, В.А. Толмачев, А.Д. Ременюк, J. Vij, A. Moore 4 417
- Магнитооптические осцилляции в висмуте при температурах $T \geq 77$ К. О.В. Кондаков, К.Г. Иванов 5 543
- Фотоэлектрические явления в монокристаллах CdV₂S₄ и структурах на их основе. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius 6 666
- Синтез и физические свойства стекол в системах Si(Ge)–Se–Te. Л.А. Кулакова, Б.Т. Мелех, В.И. Бахарев, В.Х. Кудоярова 7 822
- Оптические и электрические свойства полиамидокислоты и металл-полимерного комплекса с Tb⁺² на ее основе. Э.А. Лебедев, М.Я. Гойхман, М.Е. Компан, В.Х. Кудоярова, И.В. Подешво, Е.И. Теруков, В.В. Кудрявцев 7 844
- Исследование наведенного одноосной деформацией линейного дихроизма в кристаллах кремния. Е.Ф. Венгер, И.Е. Матяш, Б.К. Сердега 10 1188
- Спектральная эллисометрия аморфного гидрогенизированного углерода, выращенного при магнетронном распылении графита. С.Г. Ястребов, М. Гаррига, М.И. Алонсо, В.И. Иванов-Омский 10 1241
- Оптические и теплофизические свойства твердых растворов CuAl_xIn_{1-x}Te₂. И.В. Боднар 11 1285
- Эффективная масса электронов в Mn_xHg_{1-x}Te. И.М. Несмелова 11 1296
- 5.6.2. Инфракрасная спектроскопия, комбинационное рассеяние (PACS 78.30)**
- Влияние олова на реакции, протекающие с участием межуглеродного углерода в облученном кремнии. Л.И. Хируненко, О.А. Кобзарь, Ю.В. Помозов, М.Г. Соснин, Н.А. Трипачко 3 304
- Свойства нанокристаллов Ge, сформированных имплантацией ионов Ge⁺ в пленки SiO₂ и последующим отжигом под гидростатическим давлением. И.Е. Тыщенко, А.Б. Талочкин, А.Г. Черков, К.С. Журавлев, А. Мисюк, М. Фельсков, В. Скорупа 4 479
- Рамановская спектроскопия аморфного углерода, модифицированного железом. С.Г. Ястребов, В.И. Иванов-Омский, Ф. Думитраче, К. Морошану 4 490
- Квантово-химическое моделирование влияния дефектов на инфракрасный спектр и электронную структуру *a*-Se. А.С. Зюбин, Ф.В. Григорьев, С.А. Дембовский 5 616
- The influence of deposition conditions and alloying on the electronic properties of amorphous selenium. S.O. Kasap, K.V. Koughia, B. Fogal, G. Belev, R.E. Johanson 7 816
- Синтез и физические свойства стекол в системах Si(Ge)–Se–Te. Л.А. Кулакова, Б.Т. Мелех, В.И. Бахарев, В.Х. Кудоярова 7 822
- Влияние примесей редкоземельных элементов на фотолюминесценцию стеклообразного Ge₂S₃. А.А. Бабаев, И.К. Камилов, З.В. Вагабова, С.М. Султанов, А.М. Асхабов, Е.И. Теруков, И.Н. Трапезникова 7 827
- 5.6.3. Люминесценция, излучательная рекомбинация (PACS 78.55; 78.60)**
- Размерный эффект двухфотонного поглощения рекомбинационного излучения в варизонных твердых растворах Al_xGa_{1-x}As. В.Ф. Коваленко, С.В. Шутов 1 39
- Влияние заряженных дефектов на обнаружение электронного парамагнитного резонанса в стеклообразных халькогенидных полупроводниках. Л.П. Гинзбург 1 83
- Особенности электролюминесценции инжекционных лазеров на основе вертикально-связанных квантовых точек вблизи порога лазерной генерации. Н.Ю. Гордеев, С.В. Зайцев, Л.Я. Карачинский, В.И. Копчатов, И.И. Новиков, В.М. Устинов, П.С. Копьев 1 114
- Особенности определения концентраций мелких примесей в полупроводниках из анализа спектров краевой люминесценции. К.Д. Глинчук, А.В. Прохорович 2 159
- Фотолюминесценция квантовых ям и квантовых точек германия в кремнии, полученных при низких температурах молекулярно-пучковой эпитаксии. Т.М. Бурбаев, В.А. Курбатов, А.О. Погосов, М.М. Рзаев, Н.Н. Сибельдин 2 216
- Фотоэлектрические свойства пленок ZnO, легированных акцепторными примесями Cu и Ag. А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков, Е.Е. Якимов 3 275

- Термический перенос заряда и поляризация широкой полосы люминесценции с максимумом при энергии фотонов вблизи 1.2 эВ в *n*-GaAs:Te при одноосной деформации. А.А. Гуткин, М.А. Решиков 3 287
- Влияние отжига в парах и в жидком Zn на фотолюминесценцию высокочистых поликристаллов ZnTe. В.С. Багаев, В.В. Зайцев, Ю.В. Клевков, В.С. Кривобок, Е.Е. Онищенко 3 299
- Слоистое строение пленок $Zn_{1-x}Cd_xSe$, выращенных газофазной эпитаксией из металлорганических соединений на подложках $Cd_{0.92}Zn_{0.08}S$ (0001). В.П. Мартовицкий, В.И. Козловский, П.И. Кузнецов, Я.К. Скасырский, Г.Г. Якушева 3 310
- Люминесценция квантовых точек ZnO, полученных с помощью синтетического опала. А.Н. Грузинцев, В.Т. Волков, Г.А. Емельченко, И.А. Карпов, В.М. Масалов, Г.М. Михайлов, Е.Е. Якимов 3 330
- Исследования физических явлений в полупроводниковых наноструктурах с использованием планарно-неоднородных слоев. 1. Фотолюминесценция. Ю.В. Хабаров 3 339
- Спектры фотолюминесценции нанокристаллов кремния. Э.Б. Каганович, Э.Г. Манойлов, И.Р. Базылюк, С.В. Свечников 3 353
- Рекомбинационная неустойчивость тока в эпитаксиальных p^+ - n -структурах с локально введенными в n -область примесными атомами и определение параметров глубоких центров на ее основе. Б.С. Муравский, О.Н. Куликов, В.Н. Черный 4 393
- Свойства нанокристаллов Ge, сформированных имплантацией ионов Ge^+ в пленки SiO_2 и последующим отжигом под гидростатическим давлением. И.Е. Тысченко, А.Б. Талочкин, А.Г. Черков, К.С. Журавлев, А. Мисюк, М. Фельсков, В. Скорупа 4 479
- Электролитический способ приготовления пористого кремния с использованием внутреннего источника тока. Д.Н. Горячев, Л.В. Беляков, О.М. Сресели 4 494
- 3С-SiC p - n -структуры, полученные методом сублимации на основе подложек 6H-SiC. А.А. Лебедев, А.М. Стрельчук, Д.В. Давыдов, Н.С. Савкина, А.С. Трегубова, А.Н. Кузнецов, В.А. Соловьев, Н.К. Полетаев 4 499
- Локальная особенность изменения спектра пикосекундной суперлюминесценции при дополнительной генерации носителей в нефермиевскую электронно-дырочную плазму в GaAs. Н.Н. Агеева, И.Л. Броневои, А.Н. Кривоносов, С.Е. Кумеков, С.В. Стеганцов 5 546
- Фононная люминесценция экситонов в слоях GaN, выращенных методами молекулярно-пучковой и хлорид-гидридной газофазной эпитаксии. М.Г. Ткачман, Т.В. Шубина, В.Н. Жмерик, С.В. Иванов, П.С. Копьев, Т. Паскова, Б. Монемар 5 552
- Фотолюминесцентные исследования двойных квантовых ям AlGaAs/GaAs/AlGaAs с тонким разделяющим AlAs-слоем. Г.Б. Галиев, М.В. Карачевцева, В.Г. Мокеров, В.А. Страхов, Г.Н. Шкердин, Н.Г. Яременко 5 599
- Сверхизлучение в квантовых гетероструктурах. А.И. Климовская, Ю.А. Дрига, Е.Г. Гуле, О.А. Пикарук 6 706
- Низкотемпературная антистоксова фотолюминесценция в наноструктурах CdSe/ZnSe. М.Я. Валах, Н.В. Вуйчик, В.В. Стрельчук, С.В. Сорокин, Т.В. Шубина, С.В. Иванов, П.С. Копьев 6 724
- Влияние имплантации ионов Р на фотолюминесценцию нанокристаллов Si в слоях SiO_2 . Г.А. Качурин, С.Г. Яновская, Д.И. Тетельбаум, А.Н. Михайлов 6 738
- Эффективный кремниевый светодиод с температурно-стабильными спектральными характеристиками. А.М. Емельянов, Н.А. Соболев, Т.М. Мельникова, S. Pizzini 6 756
- Влияние низкой концентрации примеси Au на фотолюминесценцию стехио- и нестехиометрического состава сульфида мышьяка. А.А. Бабаев, И.К. Камиллов, З.В. Вагабова, С.М. Султанов, А.М. Асхабов, Е.И. Теруков, И.Н. Трапезникова 7 776
- Влияние примесей редкоземельных элементов на фотолюминесценцию стеклообразного Ge_2S_3 . А.А. Бабаев, И.К. Камиллов, З.В. Вагабова, С.М. Султанов, А.М. Асхабов, Е.И. Теруков, И.Н. Трапезникова 7 827
- Органические материалы для фотовольтаических и светоизлучающих устройств. Т.А. Юрре, Л.И. Рудая, Н.В. Климова, В.В. Шаманин 7 835
- Теоретические и экспериментальные исследования влияния скорости роста InAs на свойства ансамблей квантовых точек в системе InAs/GaAs. В.Г. Дубровский, В.А. Егоров, Г.Э. Цырлин, Н.К. Поляков, Ю.Б. Самсоненко, Н.В. Крыжановская, А.Ф. Цацульников, В.М. Устинов 7 883
- Анализ полосы излучения комплексов $V_{Ga}Te_{As}$ в n -GaAs при одноосном давлении. А.А. Гуткин, А.В. Ермакова 8 908
- Отрицательная люминесценция на длине волны 3.9 мкм в диодах на основе InGaAsSb. М. Айдаралиев, Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, М.А. Ременный, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин 8 951
- Спектры микрофотолюминесценции теллурида кадмия, полученного в неравновесных условиях. В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков 9 1067
- Влияние условий молекулярно-лучевой эпитаксии на захват кремния в подрешетки А и В арсенида галлия. И.А. Бобровникова, М.Д. Вилисова, И.В. Ивонин, Л.Г. Лаврентьева, В.В. Преображенский, М.А. Путято, Б.Р. Семягин, С.В. Субач, С.Е. Торопов 9 1072
- Оптические и структурные свойства твердых растворов InGaAsP, полученных способом МОС-гидридной эпитаксии на подложках GaAs(001) в области несмешиваемости. Л.С. Вавилова, Д.А. Винокуров, В.А. Капитонов, А.В. Мурашова, В.Н. Неведомский, Н.К. Полетаев, А.А. Ситникова, И.С. Тарасов, В.В. Шамахов 9 1104
- Зависимость энергии активации $A(+)$ -центров от ширины квантовых ям в структурах GaAs/AlGaAs. Ю.Л. Иванов, П.В. Петров, А.А. Тонких, Г.Э. Цырлин, В.М. Устинов 9 1114
- Эффективное сечение возбуждения фотолюминесценции и время жизни в возбужденном состоянии ионов Eg^{3+} в многослойных селективно легированных Si: Eg-структурах. С.В. Гастев, А.М. Емельянов, Н.А. Соболев, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник, В.Б. Шмагин 9 1123

- Электрические свойства и спектры люминесценции светодиодов на основе гетеропереходов InGaN/GaN с модулированно-легированными квантовыми ямами. С.С. Мамакин, А.Э. Юнович, А.Б. Ваттана, Ф.И. Маняхин 9 1131
- Фотолюминесценция аморфного углерода, выращенного лазерной абляцией графита. С.Г. Ястребов, В.И. Иванов-Омский, А. Рихтер 10 1193
- Электролюминесценция в полуметаллическом канале на одиночной разбедненной гетерогранице II типа. К.Д. Моисеев, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев, И. Освальд, Э. Гулицус, И. Панграц, Т. Шимчек . 10 1214
- Дефектная люминесценция пленок GaN:Zn, отожженных в высокочастотной плазме аммиака. Г.А. Сукач, В.В. Кидалов, А.И. Власенко, Е.П. Потапенко 11 1290
- Влияние межзеренных границ раздела на свойства теллурида кадмия, полученного в неравновесных условиях. В.В. Ушаков, Ю.В. Клевков 11 1298
- Ультрафиолетовая люминесценция тонких пленок GaN, полученных методом радикало-лучевой геттерирующей эпитаксии на пористых подложках GaAs (111). В.В. Кидалов, Г.А. Сукач, А.С. Ревенко, Е.П. Потапенко 11 1303
- Фотолюминесценция нанокластеров сульфида кадмия, сформированных в матрице пленки Ленгмюра-Блоджетт. Е.А. Багаев, К.С. Журавлев, Л.Л. Свешникова, И.А. Бадмаева, С.М. Репинский, М. Voelskow 11 1358
- Экситонная рекомбинация около края подвижности в CdSe/ZnSe-наноструктурах. М.Я. Валах, М.П. Лисица, В.В. Стрельчук, Н.В. Вуйчик, С.В. Иванов, А.А. Торопов, Т.В. Шубина, П.С. Копьев 11 1374
- Фотолюминесценция в области 1.5 мкм механически обработанных слоев монокристаллического кремния. Р.И. Баталов, Р.М. Баязитов, Б.А. Андреев, Д.И. Крыжков, Е.И. Теруков, В.Х. Кудоярова 12 1427
- Фотонные кристаллы на основе композитов опал-GaP и опал-GaN:P: получение и оптические свойства. Г.М. Гаджиев, В.Г. Голубев, М.В. Заморянская, Д.А. Курдюков, А.В. Медведев, J. Merz, A. Mintairov, А.Б. Певцов, А.В. Селькин, В.В. Травников, Н.В. Шаренкова 12 1449
- 5.6.4. Оптические свойства тонких пленок, поверхностей и структур, содержащих границы раздела (сверхрешетки, гетеропереходы и т. п.) (PACS 78.66)**
- Размерный эффект двухфотонного поглощения рекомбинационного излучения в варизонных твердых растворах $Al_xGa_{1-x}As$. В.Ф. Коваленко, С.В. Шутков 1 39
- Фотоэлектрические свойства гетеропереходов кремний-полигемосопряженные элементорганические соединения. Н.В. Блинова, Е.Л. Краснопева, Ю.А. Николаев, А.Ю. Осадчев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, В.В. Шаманин 1 53
- Влияние водородной плазмы на спектр электроотражения и спектр электронных состояний пористого кремния. Е.Ф. Венгер, Р.Ю. Голиней, Л.А. Матвеева, А.В. Васин 1 104
- Оптические свойства фуллеренсодержащих свободных пленок полидиметилфениленоксида. Ю.Ф. Бирюлин, Е.Ю. Меленевская, С.Н. Миков, С.Е. Орлов, В.Д. Петриков, Д.А. Сыкманов, В.Н. Згонник 1 110
- Синтез новых углерод-азотных нанокластеров при термическом отжиге в атмосфере азота алмазоподобных пленок углерода. И.А. Файзрахманов, В.В. Базаров, Н.В. Курбатова, И.Б. Хайбуллин, А.Л. Степанов 2 230
- Влияние термического отжига на оптические и фотоэлектрические свойства пленок микрокристаллического гидрированного кремния. А.Г. Казанский, Х. Мелл, П.А. Форш 2 235
- Слоистое строение пленок $Zn_{1-x}Cd_xSe$, выращенных газовой эпитаксией из металлоорганических соединений на подложках $Cd_{0.92}Zn_{0.08}S$ (0001). В.П. Мартовицкий, В.И. Козловский, П.И. Кузнецов, Я.К. Скасырский, Г.Г. Якушева 3 310
- Рамановская спектроскопия аморфного углерода, модифицированного железом. С.Г. Ястребов, В.И. Иванов-Омский, Ф. Думитраче, К. Морошану 4 490
- Фоновая люминесценция экситонов в слоях GaN, выращенных методами молекулярно-лучевой и хлорид-гидридной газовой эпитаксии. М.Г. Ткачман, Т.В. Шубина, В.Н. Жмерик, С.В. Иванов, П.С. Копьев, Т. Паскова, Б. Монемар . 5 552
- Структурные и оптические свойства квантовых точек InAs в матрице AlGaAs. Д.С. Сизов, Ю.Б. Самсоненко, Г.Э. Цырлин, Н.К. Поляков, В.А. Егоров, А.А. Тонких, А.Е. Жуков, С.С. Михрин, А.П. Васильев, Ю.Г. Мусихин, А.Ф. Цацульников, В.М. Устинов, Н.Н. Леденцов 5 578
- Электронные и оптические свойства сверхрешеток $AlAs/Al_xGa_{1-x}As$ (110). Г.Ф. Караваев, В.Н. Чернышов, Р.М. Егунов 5 592
- Фотолюминесцентные исследования двойных квантовых ям AlGaAs/GaAs/AlGaAs с тонким разделяющим AlAs-слоем. Г.Б. Галиев, М.В. Карачевцева, В.Г. Мокеров, В.А. Страхов, Г.Н. Шкердин, Н.Г. Яременко 5 599
- Получение и свойства монокристаллов $ZnFe_2S_4$ и структур на их основе. А.А. Вайполин, Ю.А. Николаев, И.К. Полушина, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, N. Fernelius 6 681
- Сверхизлучение в квантовых гетероструктурах. А.И. Климовская, Ю.А. Дрига, Е.Г. Гуле, О.А. Пикарук 6 706
- Низкотемпературная антистоксова фотолюминесценция в наноструктурах CdSe/ZnSe. М.Я. Валах, Н.В. Вуйчик, В.В. Стрельчук, С.В. Сорокин, Т.В. Шубина, С.В. Иванов, П.С. Копьев 6 724
- Модификация наноструктуры алмазоподобных пленок углерода бомбардировкой ионами ксенона. И.А. Файзрахманов, В.В. Базаров, А.Л. Степанов, И.Б. Хайбуллин 6 748
- III Международная конференция „Аморфные и микрокристаллические полупроводники“. Е. Теруков Е. 7 769
- Влияние примесей редкоземельных элементов на фотолюминесценцию стеклообразного Ge_2S_3 . А.А. Бабаев, И.К. Камиллов, З.В. Вагабова, С.М. Султанов, А.М. Асхабов, Е.И. Теруков, И.Н. Трапезникова 7 827

- Органические материалы для фотовольтаических и светоизлучающих устройств. Т.А. Юрре, Л.И. Рудая, Н.В. Климова, В.В. Шаманин 7 835
- Светочувствительные свойства новых фотопроводящих полимеров на основе бихинолиловых комплексов рутения. Е.Л. Александрова, М.Я. Гойхман, И.В. Подешво, И.В. Гофман, В.В. Кудрявцев 7 846
- Оптические и светочувствительные свойства гребнеобразных полиамидоимидов. Е.Л. Александрова, М.Я. Гойхман, Л.И. Субботина, К.А. Ромашкова, И.Ф. Гофман, В.В. Кудрявцев, А.В. Якиманский . . . 7 849
- Изучение влияния кислорода на интенсивность фотолуминесценции эрбия в пленках $a\text{-SiO}_x:\text{H}(\text{Er})$, полученных магнетронным способом. Ю.К. Ундалов, Е.И. Теруков, О.Б. Гусев, В.Х. Кудоярова 7 853
- Расщепление резонансных оптических мод в микрорезонаторах Фабри—Перо. В.Г. Голубев, А.А. Дукин, А.В. Медведев, А.Б. Певцов, А.В. Селькин, Н.А. Феоктистов 7 860
- Управление параметрами массивов квантовых точек InAs—GaAs в режиме роста Странского—Крастанова. Н.А. Черкашин, М.В. Максимов, А.Г. Макаров, В.А. Щукин, В.М. Устинов, Н.В. Луковская, Ю.Г. Мухомин, Г.Э. Цырлин, Н.А. Берг, Ж.И. Алфёров, Н.Н. Леденцов, Д. Бимберг 7 890
- Отрицательная люминесценция на длине волны 3.9 мкм в диодах на основе InGaAsSb. М. Айдаралиев, Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, М.А. Ременный, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин 8 951
- Рамановская и инфракрасная спектроскопия нанокристаллов GaN, выращенных хлорид-гидридной эпитаксией на оксидированном кремнии. В.Н. Бесолов, Ю.В. Жилияев, Е.В. Коленкова, В.А. Федирко, D.R.T. Zahn 8 964
- Электролюминесценция в полуметаллическом канале на одиночной разьединенной гетерогранице II типа. К.Д. Моисеев, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев, И. Освальд, Э. Гулициус, И. Панграц, Т. Шимечек . 10 1214
- Спектральная эллипсометрия аморфного гидрогенизированного углерода, выращенного при магнетронном распылении графита. С.Г. Ястребов, М. Гаррига, М.И. Алонсо, В.И. Иванов-Омский . . 10 1241
- Фоточувствительные структуры на кристаллах In_2S_3 . И.В. Боднар, В.А. Полубок, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь 11 1346
- Модифицирование нанокластеров германия в кремнии под действием импульсного лазерного излучения. В.А. Володин, Е.И. Гацкевич, А.В. Двуреченский, М.Д. Ефремов, Г.Д. Ивлев, А.И. Никифоров, Д.А. Орехов, А.И. Якимов 11 1352
- Оптические свойства сверхтонких внедрений соединения GaAsN в GaAs, полученных методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, А.Р. Ковш, И.П. Сошников, А.Ф. Цацульников, Н. Kirmse, W. Neumann, J.Y. Chi, J.S. Wang, L. Wei, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов . . 11 1363
- Самопроизвольное формирование периодической наноструктуры с модуляцией состава в пленках $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$. П.А. Бахтин, В.С. Варавин, С.А. Дворецкий, А.Ф. Кравченко, А.В. Латышев, Н.Н. Михайлов, И.В. Сабина, Ю.Г. Сидоров, М.В. Якушев 11 1369
- Фотолуминесценция в области 1.5 мкм механически обработанных слоев монокристаллического кремния. Р.И. Баталов, Р.М. Баязитов, Б.А. Андреев, Д.И. Крыжков, Е.И. Теруков, В.Х. Кудоярова 12 1427
- 5.7. Эмиссия электронов и ионов. Ударная ионизация (PACS 79)**
- Полиамидиновые супрамолекулярные структуры — новый класс светочувствительных полимерных полупроводников. Е.Л. Александрова, М.М. Дудкина, А.В. Теньковцев 3 282
- Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия и рентгеновский микроанализ монокристаллов на основе теллурида висмута. И.В. Гасенкова, В.А. Чубаренко, Е.А. Тьяловская, Т.Е. Свечникова . 6 661
- 6. Технология, материаловедение, применение полупроводников (PACS 80)**
- 6.1. Методы получения и обработки полупроводниковых материалов (PACS 81; 82)**
- Математическое моделирование кинетики высокотемпературного окисления кремния и структуры пограничного слоя в системе Si—SiO₂. Г.Я. Красников, Н.А. Зайцев, И.В. Матюшкин 1 44
- Фазово-структурные превращения в пленках SiO_x в процессе вакуумных термообработок. И.П. Лисовский, И.З. Индутный, Б.Н. Гненный, П.М. Литвин, Д.О. Мазунов, А.С. Оберемок, Н.В. Сопинский, П.Е. Шепелявый 1 98
- Влияние водородной плазмы на спектр электроотражения и спектр электронных состояний пористого кремния. Е.Ф. Венгер, Р.Ю. Голиней, Л.А. Матвеева, А.В. Васин 1 104
- Сегрегация индия при выращивании квантовых ям InGaAs/GaAs в условиях газовой эпитаксии. Ю.Н. Дроздов, Н.В. Байдусь, Б.Н. Звонков, М.Н. Дроздов, О.И. Хрыкин, В.И. Шашкин 2 203
- Синтез новых углерод-азотных нанокластеров при термическом отжиге в атмосфере азота алмазоподобных пленок углерода. И.А. Файзрахманов, В.В. Базаров, Н.В. Курбатова, И.Б. Хайбуллин, А.Л. Степанов 2 230
- О внутреннем квантовом выходе стимулированного излучения InGaAsP/InP-гетеролазеров ($\lambda = 1.55$ мкм). Г.В. Скрынников, Г.Г. Зегря, Н.А. Пихтин, С.О. Слипенченко, В.В. Шамахов, И.С. Тарасов 2 243
- Трансформация параметров фазового перехода полупроводник—металл при кристаллизации аморфных пленок диоксида ванадия. В.А. Климов, И.О. Тимофеева, С.Д. Ханин, Е.Б. Шадрин, А.В. Ильинский, Ф. Сильва-Андрате 4 388
- Электрофизические свойства InAs, облученного протонами. В.Н. Брудный, Н.Г. Колин, А.И. Потапов 4 408
- Двулучепреломление инфракрасного света в искусственном кристалле, полученном с помощью анизотропного травления кремния. Е.В. Астрова, T.S. Perova, В.А. Толмачев, А.Д. Ременюк, J. Vij, A. Moore 4 417

- Характеристики арсенидгаллиевых структур и приборов Ганна на их основе, изготовленных с применением радиационно-термической технологии. М.В. Ардышев, В.М. Ардышев 4 456
- Влияние обработки ионами Ag низких энергий на характеристики рабочей и тыльной сторон подложки монокристаллического GaAs. А.С. Алалыкин, П.Н. Крылов, И.В. Федотова, А.Б. Федотов 4 465
- Исследование слоев пористого кремния лазерным ультразвуковым методом. С.М. Жаркий, А.А. Карабутов, И.М. Пеливанов, Н.Б. Подымова, В.Ю. Тимошенко 4 485
- Электролитический способ приготовления пористого кремния с использованием внутреннего источника тока. Д.Н. Горячев, Л.В. Беляков, О.М. Сресели . . 4 494
- Фононная люминесценция экситонов в слоях GaN, выращенных методами молекулярно-пучковой и хлорид-гидридной газофазной эпитаксии. М.Г. Ткачман, Т.В. Шубина, В.Н. Жмерик, С.В. Иванов, П.С. Копьев, Т. Паскова, Б. Монемар . 5 552
- Полуизолирующие слои карбида кремния, полученные диффузией ванадия в пористый 4H-SiC. М.Г. Мынбаева, А.А. Лаврентьев, Н.И. Кузнецов, А.Н. Кузнецов, К.Д. Мынбаев, А.А. Лебедев 5 612
- Обнаружение примеси водорода в кремниевых детекторах излучения. Л.Ф. Макаренко, Ф.П. Коршунов, С.Б. Ластовский, Н.И. Замятин 5 629
- Водородно-индуцированное скалывание в кремнии по заглубленному слою, сильно легированному бором. Д.В. Киланов, В.П. Попов, Л.Н. Сафронов, А.И. Никифоров, Р. Шольц 6 644
- Defect profiling in semiconductor layers by electrochemical method. Ákos Nemcsics, János P. Makai . . 6 657
- Фуллереновые микрокристаллы как адсорбенты органических соединений. В.И. Березкин, И.В. Викторовский, А.Я. Вуль, Л.В. Голубев, В.Н. Петрова, Л.О. Хорошко 7 802
- Легирование магнием в молекулярно-пучковой эпитаксии нитрида галлия из активированного азота. А.А. Воробьев, В.В. Кораблев, С.Ю. Карпов 7 866
- Оптические и структурные свойства твердых растворов InGaAsP, полученных способом МОС-гидридной эпитаксии на подложках GaAs(001) в области несмешиваемости. Л.С. Вавилова, Д.А. Винокуров, В.А. Капитонов, А.В. Мурашова, В.Н. Неведомский, Н.К. Полетаев, А.А. Ситникова, И.С. Тарасов, В.В. Шамахов 9 1104
- Фотоосаждение металла в гетеропереходах с твердым электролитом. Случай гетеропереходов CdSe-As₂S₃: Ag_x (x = 0.9–2.4). А.И. Стецун . . . 10 1197
- Формирование структуры собственного оксида на поверхности n-GaAs при естественном окислении на воздухе. Н.А. Торхов 10 1205
- Ультрафиолетовая люминесценция тонких пленок GaN, полученных методом радикало-лучевой геттерирующей эпитаксии на пористых подложках GaAs (111). В.В. Кидалов, Г.А. Сукач, А.С. Ревенко, Е.П. Потапенко 11 1303
- Гальваномагнитные эффекты в атомно-разупорядоченных соединениях HgSe_{1-x}S_x. А.Е. Карькин, В.В. Щенников, С.Е. Данилов, В.А. Арбузов, Б.Н. Гощицкий 11 1316
- О влиянии реальной поверхности монокристаллического Si на низкочастотное внутреннее трение и поведение эффективного модуля сдвига. А.В. Олейнич-Лысюк, Н.П. Бешлей, И.М. Фодчук . 11 1337
- Кинетика начальной стадии халькогенидной пассивации полупроводников A^{III}B^V. В.Ф. Антюшин, А.В. Буданов, Д.С. Кухаренко, Д.А. Палишкин . . . 11 1349
- Модифицирование нанокластеров германия в кремнии под действием импульсного лазерного излучения. В.А. Володин, Е.И. Гацкевич, А.В. Двуреченский, М.Д. Ефремов, Г.Д. Ивлев, А.И. Никифоров, Д.А. Орехов, А.И. Якимов 11 1352
- Перераспределение иттербия и кислорода при отжиге аморфизованных имплантацией слоев кремния. О.В. Александров, Ю.А. Николаев, Н.А. Соболев, R. Asomoza, Yu. Kudriavtsev, A. Villegas, A. Godines 12 1409
- Фотолюминесценция в области 1.5 мкм механически обработанных слоев монокристаллического кремния. Р.И. Баталов, Р.М. Байзитов, Б.А. Андреев, Д.И. Крыжков, Е.И. Теруков, В.Х. Кудоярова 12 1427
- Фотонные кристаллы на основе композитов опал-GaP и опал-GaPN: получение и оптические свойства. Г.М. Гаджиев, В.Г. Голубев, М.В. Заморянская, Д.А. Курдюков, А.В. Медведев, J. Merz, A. Mintairov, А.Б. Певцов, А.В. Селькин, В.В. Травников, Н.В. Шаренкова 12 1449

6.2. Полупроводниковые приборы (PACS 84; 85)

- Исследование магниточувствительности транзисторных структур с диффузионным переносом инжектированных носителей. М.А. Глауберман, В.В. Егоров, В.В. Козел, Н.А. Канищева 1 32
- Шумовые характеристики кремниевых p-n-структур с тонкой областью умножения при термическом отжиге радиационных дефектов. О.К. Барановский, П.В. Кучинский, Е.Д. Савенок 1 50
- Фотоэлектрические свойства гетеропереходов кремний-поллигмосопряженные элементорганические соединения. Н.В. Блинова, Е.Л. Краснопева, Ю.А. Николаев, А.Ю. Осадчев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков, В.В. Шаманин 1 53
- Карбид-кремниевые транзисторные структуры как детекторы слабоионизирующего излучения. Н.Б. Строган, А.М. Иванов, М.Е. Бойко, Н.С. Савкина, А.М. Стрельчук, А.А. Лебедев, Р. Якимова 1 65
- Туннельная рекомбинация в кремниевых лавинных диодах. С.В. Булярский, В.К. Ионычев, В.В. Кузьмин 1 117
- Электрические свойства поверхности-барьерных диодов на основе CdZnTe. Л.А. Косяченко, И.М. Раренко, З.И. Захарчук, В.М. Склярчук, Е.Ф. Склярчук, И.В. Солончук, И.С. Кабанова, Е.Л. Масляничук 2 238
- О внутреннем квантовом выходе стимулированного излучения InGaAsP/InP-гетеролазеров ($\lambda = 1.55$ мкм). Г.В. Скрынников, Г.Г. Зегря, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, В.В. Шамахов, И.С. Тарасов 2 243
- Туннельная эмиссия электронов в фотопольевых детекторах и в оже-транзисторе в сверхсильных электрических полях. В.Д. Калганов, Н.В. Милешкина, Е.В. Остроумова 3 372

- Транспорт в сверхрешетках со слабыми барьерами и проблема терагерцового блоховского генератора. А.А. Андронов, И.М. Нефедов, А.В. Соснин 3 378
- Влияние внутренних полей на туннельный ток в напряженных структурах GaN/Al_xGa_{1-x}N(0001). С.Н. Гриняев, А.Н. Разжувалов 4 450
- Тепловая и токовая перестройка длины волны излучения квантово-размерных лазеров диапазона 2.0–2.4 мкм. А.П. Астахова, А.Н. Баранов, А. Висе, А.Н. Именков, Н.М. Колчанова, Н.Д. Стоянов, А. Черняев, Д.А. Яреха, Ю.П. Яковлев 4 502
- Искусственные подложки GeSi для гетероэпитаксии — достижения и проблемы. Ю.Б. Болховитянов, О.П. Пчеляков, Л.В. Соколов, С.И. Чикичев 5 513
- Модель многоостровковых одноэлектронных цепочек на основе метода Монте-Карло. И.И. Абрамов, С.А. Игнатенко, Е.Г. Новик 5 583
- Визуализация заросших наноструктур GeSi в кремниевых структурах методом атомно-силовой микроскопии на сколах. М.С. Дунаевский, З.Ф. Красильник, Д.Н. Лобанов, А.В. Новиков, А.Н. Титков, R. Laiho 6 692
- Эффективный кремниевый светодиод с температурно-стабильными спектральными характеристиками. А.М. Емельянов, Н.А. Соболев, Т.М. Мельникова, S. Pizzini 6 756
- Инжекционный ИК лазер ($\lambda = 2.775$ мкм) на основе двойной гибридной гетероструктуры AlGaAsSb/InAs/CdMgSe, выращенной методом молекулярно-пучковой эпитаксии. С.В. Иванов, К.Д. Моисеев, В.А. Кайгородов, В.А. Соловьев, С.В. Сорокин, Б.Я. Мельцер, Е.А. Гребенщикова, И.В. Седова, Я.В. Терентьев, А.Н. Семенов, А.П. Астахова, М.П. Михайлова, А.А. Торопов, Ю.П. Яковлев, П.С. Копьев, Ж.И. Алфёров 6 762
- Органические материалы для фотовольтаических и светонизлучающих устройств. Т.А. Юрре, Л.И. Рудая, Н.В. Климова, В.В. Шаманин 7 835
- Фоточувствительные структуры на монокристаллах фосфида бора. Ю.А. Николаев, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, Е.И. Теруков 8 947
- Фотоприемники ультрафиолетового излучения на основе структур металл–широкозонный полупроводник. Т.В. Бланк, Ю.А. Гольдберг, Е.В. Калинина, О.В. Константинов, Е.А. Поссе 8 968
- Высокоэффективные фотодиоды на основе GaInAsSb/GaAlAsSb для спектрального диапазона 0.9–2.55 мкм с большим диаметром чувствительной площадки. И.А. Андреев, Н.Д. Ильинская, Е.В. Куницына, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев 8 974
- Свойства светодиодов, изготовленных на основе структур InAsSbP/InAsSb, выращенных методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений. Н.В. Зотова, С.С. Кижасев, С.С. Молчанов, Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, Б.В. Пушный, Ю.П. Яковлев 8 980
- Высокоэффективные светодиоды спектрального диапазона 1.6–2.4 мкм для медицинской диагностики и экологического мониторинга. Н.Д. Стоянов, Б.Е. Журтанов, А.П. Астахова, А.Н. Именков, Ю.П. Яковлев 8 996
- Особенности спонтанного и когерентного инфракрасного излучения лазеров, изготовленных на основе одиночного разьединенного гетероперехода II типа. К.Д. Моисеев, М.П. Михайлова, Ю.П. Яковлев 8 1010
- Эффективное сечение возбуждения фотолуминесценции и время жизни в возбужденном состоянии ионов Er³⁺ в многослойных селективно легированных Si:Er-структурах. С.В. Гастев, А.М. Емельянов, Н.А. Соболев, Б.А. Андреев, З.Ф. Красильник, В.Б. Шмагин 9 1123
- Электрические свойства и спектры люминесценции светодиодов на основе гетеропереходов InGaN/GaN с модулированно-легированными квантовыми ямами. С.С. Мамакин, А.Э. Юнович, А.Б. Вагтана, Ф.И. Маняхин 9 1131
- Фазовые и структурные изменения в многослойных контактах к n-GaAs, стимулированные быстрыми термическими обработками. Н.С. Болтовец, В.Н. Иванов, Р.В. Конакова, П.М. Литвин, О.С. Литвин, В.В. Миленин, И.В. Прокопенко 9 1138
- Метаморфные лазеры спектрального диапазона 1.3 мкм, выращенные методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложках GaAs. А.Е. Жуков, А.Р. Ковш, С.С. Михрин, Е.С. Семенова, Н.А. Малеев, А.П. Васильев, Е.В. Никитина, Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, Ю.М. Шерняков, Ю.Г. Мусихин, М.В. Максимов, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, Ж.И. Алфёров 9 1143
- О быстром восстановлении блокирующей способности карбид-кремниевых диодов. И.В. Грехов, А.С. Кюрегян, Т.Т. Мнацаканов, С.Н. Юрков 9 1148
- Модифицирование свойств Hg_{1-x}Cd_xTe низкокэнергетичными ионами. К.Д. Мынбаев, В.И. Иванов-Омский 10 1153
- Резонансное комбинационное рассеяние света в наноструктурах Ge, сформированных на подложке Si(111), покрытой ультратонким слоем SiO₂. В.А. Володин, М.Д. Ефремов, А.И. Никифоров, Д.А. Орехов, О.П. Пчеляков, В.В. Ульянов 10 1220
- Электронный транспорт в униполярных гетероструктурных транзисторах с квантовыми точками в сильных электрических полях. В.Г. Мокеров, Ю.К. Пожела, Ю.В. Федоров 10 1248
- Нанотранзисторы кремний-на-изоляторе: перспективы и проблемы реализации. О.В. Наумова, И.В. Антонова, В.П. Попов, Ю.В. Настаушев, Т.А. Гаврилова, Л.В. Литвин, А.Л. Асеев 10 1253
- Влияние облучения быстрыми нейтронами на электрические характеристики приборов на основе CVD эпитаксиальных слоев 4H-SiC. Е.В. Калинина, Г.Ф. Холуянов, Д.В. Давыдов, А.М. Стрельчук, А. Hallén, А.О. Константинов, В.В. Лучинин, А.Ю. Никифоров 10 1260
- Конструкция и технология изготовления вертикально излучающих лазеров с непроводящими эпитаксиальными зеркалами. Н.А. Малеев, А.Р. Ковш, А.Е. Жуков, А.П. Васильев, С.С. Михрин, А.Г. Кузьменков, Д.А. Бедарев, Ю.М. Задиранов, М.М. Кулагина, Ю.М. Шерняков, А.С. Шуленков, В.А. Быковский, Ю.М. Соловьев, С. Möller, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов 10 1265

- Фоточувствительные структуры на монокристаллах CdGa₂S₄.** В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь, А.А. Вайполин, И.В. Боднарь, N. Fernelius **11** 1321
- Фотодиоды Ge/Si со встроенными слоями квантовых точек Ge для ближней инфракрасной области (1.3–1.5 мкм).** А.И. Якимов, А.В. Двуреченский, А.И. Никифоров, С.В. Чайковский, С.А. Тийс **11** 1383
- Термоэлементы с боковым теплообменом.** А.А. Ащелулов, В.Г. Охрем, Е.А. Охрем **11** 1389
- 1.7–1.8 мкм лазерные диоды на основе квантово-размерных InGaAsP/InP-гетероструктур.** А.В. Лютецкий, Н.А. Пихтин, С.О. Слипченко, З.Н. Соколова, Н.В. Фетисова, А.Ю. Лешко, В.В. Шамахов, А.Ю. Андреев, Е.Г. Голикова, Ю.А. Рябоштан, И.С. Тарасов **11** 1394
- Лазерная генерация на длине волны 1.5 мкм в структурах с квантовыми точками на подложках GaAs.** А.Е. Жуков, А.П. Васильев, А.Р. Ковш, С.С. Михрин, Е.С. Семенова, А.Ю. Егоров, В.А. Одноблюдов, Н.А. Малеев, Е.В. Никитина, Н.В. Крыжановская, А.Г. Гладышев, Ю.М. Шерняков, М.В. Максимов, Н.Н. Леденцов, В.М. Устинов, Ж.И. Алфёров **12** 1461
- Свойства светодиодов на основе GaSb, полученных путем химической огранки подложечной части светодиодных кристаллов.** Е.А. Гребенщикова, А.Н. Именков, Б.Е. Журтанов, Т.Н. Данилова, А.В. Черняев, Н.В. Власенко, Ю.П. Яковлев **12** 1465
- Пикосекундные высоковольтные дрейфовые диоды на основе арсенида галлия.** А.В. Рожков, В.А. Козлов . **12** 1477
- Ударно-ионизационный волновой пробой и генерация пикосекундных сверхширокополосных и сверхвысокочастотных импульсов в дрейфовых диодах на основе GaAs с резким восстановлением.** В.А. Козлов, А.В. Рожков, А.Ф. Кардо-Сысоев **12** 1480